## H04006PCT

1/8



#### 特許協力条約に基づく国際出願願書

原本(出顧用)

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	PCT
0-2	国際出願日	22, 4, 04
0-3	(受付印)	受領印
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書 は、	
07-1	右記によって作成された。	PCT-SAFE [EASY mode] Version 3.50 (Build 0002.162)
0-5	申立て	
	出願人は、この国際出願が特許協力条約 に従って処理されることを請求する。	·
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (RO/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	H04006PCT
I	発明の名称	磁気共鳴イメージング装置
11	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
II-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
II-4ja	名称	株式会社 日立メディコ
il-4en	Name:	HITACHI MEDICAL CORPORATION
II5ja	あて名	1010047 日本国 東京都千代田区内神田一丁目1番14号
II-5en	Address:	1-14, Uchi-kanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010047 Japan
11-6	国籍(国名)	日本国 JP
11-7	住所(国名)	日本国 JP
11-8	電話番号	N3_2202_0111
II-9	l	03-3291-6392

## 原本(出顧用)

	T as Ab as III ST 1 was 1 to 00 de				
-1    -1-1	その他の出願人又は発明者との欄に記載した者は				
		出願人である (applicant only)			
111-1-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)			
III-1-4j	a 名称	株式会社 日立製作所			
-1-4e	n Name:	HITACHI LTD.			
-1-5j	a あて名	1018010			
	1	日本国			
	1	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地			
III-1-5e	n Address:	6, Surugadai 4-chome, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 1018010			
		Japan .			
III-1-6	国籍(国名)	日本国 JP			
111-1-7		日本国 JP			
III-2	その他の出願人又は発明者				
111-2-1	この欄に記載した者は	出願人である(applicant only)			
111-2-2	右の指定国についての出願人である。	米国を除く全ての指定国 (all designated States			
	A 16	except US)			
III-2-4ja		日立エンジニアリング株式会社			
III-2-4er		HITACHI ENGINEERING CO., LTD.			
III-2-5ja	あて名	3170073			
		日本国			
III-2-E	Address:	茨城県日立市幸町3丁目2番1号			
m-z-ser	Address.	2-1, Saiwai-cho 3-chome, Hitachi-shi, Ibaraki			
	Ì	3170073 Japan			
111-2-6	  国籍 (国名)	日本国 JP			
111-2-7	住所(国名)	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
III-3	その他の出願人又は発明者	日本国 JP `			
111-3-1	この欄に記載した者は	  出願人及び発明者である (applicant and inventor)			
III-3-2	右の指定国についての出願人である。	山麓へ及び先明省である (applicant and inventor)  米国のみ (US only)			
III-3-4ja	瓜名(姓名)				
III-3-4en	Name (LAST, First):	KURONE, Akira			
III-3-5ja	あて名	2770812			
		日本国			
•		千葉県柏市花野井354-4-B202			
III-3-5en	Address:	354-4-B202, Hananoi, Kashiwa-shi, Chiba			
		2770812			
		Japan			
	国籍(国名)	日本国 JP			
111-3-7	住所(国名)	日本国 JP			

## 原本(出額用)

	<b>1</b>	
111-4	その他の出願人又は発明者	
III-4-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
•	氏名(姓名)	榊原 健二
	Name (LAST, First):	SAKAKIBARA, Kenji
III-4-5ja	あて名	2770812
III-4-5en	Address:	日本国 千葉県柏市花野井621-7-B203 621-7-B203、Hananoi、Kashiwa-shi、Chiba 2770812 Japan
111-4-6	国蟒(国名)	日本国 JP
[[[-4-7	住所(国名)	
		日本国 JP
111-5 111-5-1	その他の出額人又は発明者 この欄に記載した者は	
_	右の指定国についての出願人である。	出願人及び発明者である (applicant and inventor)  米国のみ (US only)
	氏名(姓名)	木国のみ (us offly) /  竹島 弘隆
III-5-4en	Name (LAST, First):	TAKESHIMA. Hirotaka
111-5-5ja	あて名	3010044
III-5-5en	Address:	日本国 茨城県竜ヶ崎市小柴 3 — 3 — 1 6 3-3-16, Koshiba, Ryuugasaki-shi, Ibaraki 3010044
	,	Japan
III <b>~</b> 5~6	国籍(国名)	日本国 JP
111-5-7	住所(国名)	日本国 JP
111-6	その他の出願人又は発明者	
	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-6-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-6-4ja	氏名(姓名)	八尾 武
III-6-4en	Name (LAST, First):	YATSUO, Takeshi
111-6-5ja	あて名	2770812
III-6-5en	Address:	日本国 千葉県柏市花野井720−104 720-104, Hananoi, Kashiwa-shi, Chiba 2770812 Japan
111-6-6	国籍(国名)	DA国 JP
111-6-7	住所(国名)	日本国 JP
		Land 1 and 1

## 原本(出額用)

	T=	
111-7	その他の出願人又は発明者	
III-7-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-7-4ja	氏名(姓名)	渡邊 洋之
III-7-1en	Name (LAST, First):	WATANABE, Hiroyuki
111-7-5ja		3170073 日本国 茨城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所 電力・電機グループ 原子力事 業部内
III-7-5en	Address:	c/o Nuclear Systems Division, Power & Industrial Systems, HITACHI LTD., 1-1, Saiwai-cho 3-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 3170073 Japan
111-7-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-7 <b>-</b> 7	住所(国名)	日本国 JP
111-8	その他の出願人又は発明者	
111-8-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-8-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-8-4ja	氏名(姓名)	和田山 芳英
III-8-4en	Name (LAST, First):	WADAYAMA, Yoshihide
III-8-5ja	あて名	3191221 日本国 茨城県日立市大みか町7-1-1 株式会社日立製作所 日立研究所内
III-8-5en	Address:	c/o Hitachi Laboratory, HITACHI LTD., 7-1-1, Omika-cho, Hitachi-shi, Ibaraki 3191221
III-8-6	国籍(国名)	Japan
		日本国 卯
III-8-7	住所(国名)	日本国 JP

## 原本(出顧用)

II-9-1			
III-9-2   III-9-4   III-9-4   III-10-5   III-10-6   III-10-6   III-10-5   III-10-6   III-10-5   III-10-6   IIII-10-6   III-10-6   IIII-10-6   III-10-6   III-10-6	111-9		
-9-2			出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-9-5ia   Mame (LAST, First):	III- <del>9-</del> 2	右の指定国についての出願人である。	
III-9-5a   あて名   3000013   日本国   茨城県土浦市神立町 5 O 2   株式会社日立製作所   機械研究所内   C/O Mechanical Engineering Research Laboratory, HITACHI LTD., 502, Kandatsu-cho, Tsuchiura-shi, Ibaraki 3000013   Japan   日本国 JP   日本日	III-9-4ja	氏名(姓名)	本白水 博文
III-9-5en   Address:	III-9-1en	Name (LAST, First):	MOTOSHIROMIZU, Hirofumi
III-9-6   国籍(国名)   日本国 JP   日本国 JP		·	日本国 茨城県土浦市神立町502 株式会社日立製作所 機械研究所内
III-9-7   国籍(国名)   日本国 JP   日本国 JP	III-9-5en	-Address:	HITACHI LID., 502, Kandatsu-cho, Tsuchiura-shi,   Ibaraki   3000013
III-9-7   住所(国名)	III- <del>9</del> -6	国籍(国名)	
-10-1	111-9-7	住所(国名)	
III-10-2   右の指定国についての出願人である。   出願人及び発明者である (applicant and inventor)   米国のみ (US only)   鈴木 邦仁   SUZUKI, Kunihito   Suzuki, K	III-10	その他の出願人又は発明者	
III-10-4   Annual Continuation	III-10 <b>-</b> 1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
##II-10-4i a	III-10-2	右の指定国についての出願人である。	
n III-10-5j a 3170073 日本国 茨城県日立市幸町3丁目2番1号 日立エンジニアリング株式会社内 C/O HITACHI ENGINEERING CO., LTD., 2-1, Saiwai-cho 3-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 3170073 Japan 日本国 JP	III-10-4j a	氏名(姓名)	
a ST/00/3 日本国 茨城県日立市幸町3丁目2番1号 日立エンジニアリング株式会社内 C/o HITACHI ENGINEERING CO., LTD., 2-1, Saiwai-cho 3-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 3170073 Japan 日本国 JP		Name (LAST, First):	SUZUKI, Kunihito
C/o HITACHI ENGINEERING CO., LTD., 2-1, Saiwai-cho 3-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 3170073 Japan  日本国 JP	a		日本国 茨城県日立市幸町3丁目2番1号
III-10-6 国籍(国名) III-10-6 日本国 JP	III-10-5e n	Address:	c/o HITACHI ENGINEERING CO., LTD., 2-1, Saiwai-cho 3-chome, Hitachi-shi, Ibaraki 3170073
W 10 P (= 10 P)	III-10-6	国籍(国名)	l ''
	III-10-7	住所(国名)	

## 原本(出願用)

R	1/hm 1 7714 2 7/h 7 7 17 4 7 4 7			
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名  下記の者は国際機関において右	体理 (oront)		
	記のごとく出願人のために行動する。	代理人 (agent)		
•	氏名(姓名)	多田 公子		
	Name (LAST, First):	TADA, Kimiko		
IV-1-2ja	あて名	1620041		
		日本国		
IV-1-2en	Address:	東京都新宿区早稲田鶴巻町519 石垣ビル2F		
1 2 2 2 2 2 1	Address.	Ishigaki Building 2F, 519, Waseda Tsurumaki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo		
	,	1620041		
		Japan		
<b>ГV−1−3</b>	電話番号	03-3205-5950		
[V−1−4	ファクシミリ番号	03-3205-5951		
IV-1-6	代理人登録番号	100099852		
IV-2	その他の代理人	筆頭代理人と同じあて名を有する代理人		
		(additional agent(s) with the same address as		
IV-2-1ja	氏点	first named agent)		
IV-2-1ja IV-2-1en		宮川 佳三(100099760)		
	国の指定	MIYAGAWA, Keizo (100099760)		
V-1	この願書を用いてされた国際出願は、規則			
1	4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束される全てのPCT締約国を指定し、取得しうる			
l.	あらゆる種類の保護を求め、及び該当する 場合には広域と国内特許の両方を求める			
	国際出願となる。	,		
	先の国内出願に基づく優先権主張 出願日	2002年 04日 22日 /22 04 0002)		
/I−1−2	出願番号	2003年 04月 23日 (23.04.2003)		
	国名	2003-117804		
	先の国内出願に基づく優先権主張	日本国 JP		
l'		2004年 01月 23日 (23.01.2004)		
/1-2-2		2004-015232		
/1-2-3	国名	日本国 JP		
/1-3	先の国内出願に基づく優先権主張			
		2004年 04月 19日 (19.04.2004)		
/1-3-2		2004–122723		
/1-3-3		日本国 JP		
/I-4 f	<b>憂先権証明審送付の請求</b>			
I_	上記の先の出願のうち、右記の 番号のものについては、出願書	VI-1, VI-2, VI-3		
12		VI 1. VI <sup>-</sup> Z. VI <sup>-</sup> J		
1	質の認証機太太作成) 閉胞重数	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1	質の認証謄本を作成し国際事務 高へ送付することを、受理官庁 こ対して請求している。			

## 7/8

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

## 原本(出額用)

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
VIII	申立て	申立て数	1
VIII-I	発明者の特定に関する申立て	_	
VIII-2	出順し及び特許を与えられる国際出 願日における出願人の資格に関する 中立て	_	
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出 厨日における出願人の資格に関する 申立て		
VIII-4	発明者である旨の申立て(米国を指定国と する場合)	<del>-</del>	
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失 の例外に関する申立て	-	
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	顧客(申立てを含む)	8	<b>✓</b>
IX-2	明細書	35	_
IX-3	請求の範囲	4	_
IX-4	要約	1	1
IX-5	図面	18	· —
IX-7	合計	66	
	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-8	手数料計算用紙	<b>√</b>	=
1X-9	個別の委任状の原本	<b>√</b>	_
IX-17	PCT-SAFE 電子出願	_	<b>/</b>
ĭX-18	その他:	納付する手数料に相当する特許印紙を添付した書 面	
IX-18	その他:	国際事務局の口座への振込を証明する書面	The state of the s
IX-19	要約書とともに提示する図の番号	3	
IX-20	国際出願の使用言語名	日本語	
X-1	出願人、代理人又は代表者の記名押印	(n) (n)	
X-1-1	氏名(姓名)	多田 公子	
X-1-2 X-1-3	署名者の氏名 権限		
X-2	出願人、代理人又は代表者の記名押印		
X-2-1		宮川 佳三 【『読』』	
X-2-2	署名者の氏名		
X-2-3	権限		

## H04006PCT

特許協力条約に基づく国際出願願書

8/8

原本(出願用)

## 受理官庁記入欄

国際出願として提出された書類 の実際の受理の日		
図面		
受理された	•	
不足図面がある		
国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)		
特許協力条約第11条(2)に基づ く必要な補完の期間内の受理の日		
出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP	
調査手数料未払いにつき、国際 調査機関に調査用写しを送付していない	·	
	国際事務局記入欄	<u> </u>
記録原本の受理の日		
	図面 受理された 不足図面がある 国際出願として提出された審類 を補完する審類又は図面であっ てその後期間内に提出されたも のの実際の受理の日(訂正日) 特許協力条約第11条(2)に基づ く必要な補完の期間内の受理の日 出願人により特定された国際調査機関 調査手数料未払いにつき、国際 調査機関に調査用写しを送付していない	図面  受理された  不足図面がある  国際出願として提出された審類 を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(財正日) 特許協力条約第11条(2)に基づ く必要な補完の期間内の受理の日  出願人により特定された国際調査機関  関査手数料未払いにつき、国際 調査機関に調査用写しを送付していない  国際事務局記入欄

## PCT手数科計算用紙(願書付属書)

#### 原本( 出顧用 ) 原本( 出顧用 ) [この用紙は、国際出願の一部を構成せず、国際出願の用紙の枚数に算入しない] -

	Total and the second second		<del></del>		
0	受理官庁記入欄			•	
0-1	国際出願番号				
0-2	受理官庁の日付印			-	
			·•		
0-4	様式-PCT/RO/101(付属書)				
	このPCT手数料計算用紙は、				
0-4-1	右記によって作成された。		PCT-SAFE [EASY m	ode]	•
			Version 3.50 (Bu	ild 0002.162)	
0-9	出願人又は代理人の書類記号		H04006PCT		
2	出願人		株式会社 日立メ	ディコ	
12	所定の手数料の計算		金額/係数	小計 (JP\')	
12-1	送付手数料	T	4>	13000	
12-2-1	調査手数料	S	€>	97000	
12-2-2	国際調査機関		JP	* ***	
12-3	国際出願手数料				
	(最初の30枚まで)	il	116000		
12-4	30枚を越える用紙の枚数		36		
12-5	用紙1枚の手数料	(X)	1200		
12-6	合計の手数料	i2	43200		
12-7	i1 + i2 =	i	159200		
12-12	EASYによる減額	R	-8300		
12-13	国際出願手数料の合計 (i-R)	1	4>	150900	
12-17	納付するべき手数料の合計 (T+S+I+P)		4>	260900	
12-19	支払方法	- 1	送付手数料:特許		
	[		調査手数料:特許	印紙	
			国際出願手数料:	銀行口座への振込	<i>.</i>

送付手数料・調査手数料 110,000円

李利 田 四 如

——— <u></u> ご利用明細	
本日はご来店いただきありがとうございます。	
年月日   時刻   取扱店番   銀行番号  支店番号   口座番号   160 420 13.40 060 160 160 1	印紙税申告納付につき麹町
お取引内容 お取引金額 お取扱いで 残高	税務署承認済
ご案内 ************************************	*******
お受取人 東京三菱銀行 虎ノ門支店 普通 2074896	
WIPO-PCT GENEVA 様 ご 依 頼 人 タタッミャカックトッキョシッとショタタッキミコ 様	
0332055950 税込手数料 315円を いただきました	
「メインバンク」総合サービスでは、 ●残高層の金額は決済未確認の証券類を含んでいます。 ●残高の機能に「一」がある場合は、お借入れ残高を扱わします。	

「うれしい特典」 くわしくは裏面へ! がいっぱい。 インターネットホームページアドレスhttp://www.btm.co.jp/

国際出願手数料 159,200円

PCT-EASY による減額

-8,300円

合 計 150,900円

## 委 任 状

平成16年4月14日

私どもは、弁理士 多田 公子 氏、弁理士 宮川 佳三 氏 を以て代理人と して下記事項を委任します。

1. 特許協力条約に基づく国際出願

「磁気失鳴イナージング装置」

に関する一切の件



- 2. 上記出願及び指定国の指定を取下げる件
- 3. 上記出願についての国際予備審査の請求に関する一切の件並びに請求及び選択国の選択を取下げる件

あて名 日本国東京都千代田区内神田一丁目1番14号 名 称 株式会社日立メディコ 代表者 猪俣 博

## 委任状

平成 16 年 4月14日

私どもは、弁理士 多田 公子 氏、弁理士 宮川 佳三 氏 を以て代理人と して下記事項を委任します。

1. 特許協力条約に基づく国際出願

「磁気夫鳴イメージング装置」

に関する一切の件

- 2. 上記出願及び指定国の指定を取下げる件。
- 3. 上記出願についての国際予備審査の請求に関する一切の件並びに請求及び選択国の選択を取下げる件

あて名 日本国千葉県柏市花野井354-4-B202

氏 名 黒目 明

あて名 日本国千葉県柏市花野井621-7-B203

氏 名 榊原 健二人

あて名 日本国茨城県竜ヶ崎市小柴3-3-16

氏 名 竹島 弘隆

あて名 日本国千葉県柏市花野井720-104

氏 名 八尾 武









# 委任状

平成 16 年 4 月 14 日

私どもは、弁理士 多田 公子 氏、弁理士 宮川 佳三 氏 を以て代理人と して下記事項を委任します。

1. 特許協力条約に基づく国際出願

「磁気天鳴イメージング装置」

に関する一切の件

- 2. 上記出願及び指定国の指定を取下げる件
- 3. 上記出願についての国際予備審査の請求に関する一切の件並びに請求及び選択国の選択を取下げる件

あて名 日本国茨城県日立市大みか町7-1-1 株式会社日立製作所 日立研究所内 氏 名 和田山 芳英



## 明 細 書

## 磁気共鳴イメージング装置

## 技 術 分 野

5

10

15

20

25

本発明は、磁気共鳴イメージング装置(以下、MR I 装置という。) に関する。 背景 技術

MRI装置には、対向配置された一対の静磁場発生源を用いるタイプのものがあり、一対の静磁場発生源の間の空間に均一静磁場領域が形成される。被検体の撮像部位は、この均一静磁場領域に配置され撮像される。対向配置の静磁場発生源を用いるMRI装置は、円筒状の静磁場発生源を用いるタイプのMRI装置と比較して、被検体に対して開放感を与えることができ、しかも術者が被検体にアクセスしやすいという利点がある。静磁場発生源としては、一般的には、永久磁石、常電導磁石、または超電導磁石が用いられる。

一対の静磁場発生源の撮像領域側の面にはそれぞれ、傾斜磁場発生コイルと高 周波磁場発生コイルとが配置される。傾斜磁場発生コイルには、撮像パルスシー ケンスに応じてパルス状の電流が流されるため、ローレンツ力による振動を発生 する。この振動が傾斜磁場発生コイル本体及びそのケーブルから静磁場発生源に 伝導し、静磁場発生源が振動するという問題がある。

特開平2002-52004号公報には、静磁場発生源に設けた中央穴を経由して配設された支持系によって傾斜磁場コイルを支持する構成が記載されている。この支持系は、静磁場発生源とは非接触であるとともに、静磁場発生源の支持系とは機械的に分離されている。これにより、傾斜磁場発生コイルで発生した振動が静磁場発生源に伝達するのを抑制している。

上記特開平2002-52004号公報に記載されている構成は、傾斜磁場コイルがその中央部において支持系によって支持されるため、傾斜磁場コイルが変形しやすく、振動も生じやすい。このため、傾斜磁場コイルの性能(例えば、傾

斜磁場の線形性、傾斜磁場コイルの低振動性等)を向上させることが困難になる。 また、傾斜磁場コイルに電流を供給するために接続されるケーブルにも振動が生 じるが、これを低減することについては考慮されていない。さらに、傾斜磁場コ イルに電流を供給するためのケーブルおよび冷却水を循環させるための配管を外 部にどのように引き出すかに関しても考慮されていない。

### 発明の開示

5

10

15

20

25

本発明の目的は、傾斜磁場コイルとケーブルの振動を低減する構成を有するM R I 装置を提供することにある。

上記目的を達成するために、本発明の第1の態様のMRI装置は、静磁場発生源が、磁場発生コイル内部に封入された密閉容器とを含み、密閉容器は傾斜磁場発生部から発生する振動が該密閉容器を介して他に伝達されるのを防ぐために剛構造を備える。傾斜磁場発生部は、密閉容器の撮像空間側の面上に支持される。密閉容器は、剛構成を備えることにより振動しにくくなり、傾斜磁場発生部の振動によって密閉容器に生じる振動を抑制できるとともに、このような密閉容器に固定された傾斜磁場発生部の振動を抑制することができる。さらに、密閉容器自身の振動が抑制されるために傾斜磁場発生部からの振動を密閉容器を介して他に伝達しないようにすることができる。

上記剛構造は、密閉容器の撮像空間側の面とこの面に向かい合う面とを密閉容器の内部で連結する少なくとも1つの連結部を有する構成にすることが可能である。このように密閉容器の対向面同士を連結することによって、密閉容器の剛性を向上させることができる。

上記剛構造は、密閉容器の撮像空間側の面に対して向かい合う面に固定された 剛性補強部材をさらに有する構成にすることも可能である。これにより、密閉容 器の撮像空間側の面に対して向かい合う面の剛性が向上され、さらに連結部を通 して間接的に撮像空間側の面の剛性も向上される。その結果、撮像空間側の面を 厚くしなくても密閉容器の剛性を全体として高めることができるとともに、撮像 空間を広く確保することができるようになる。

上記剛性補強部材は、板状部材および格子状部材のうち少なくとも一方を含む 構成にすることができる。剛性補強部材として格子状部材を用いた場合には、密 閉容器を軽量化しつつその剛性を高めることができる。すなわち、格子状部材を 用いることにより、剛性補強部材を備えたことによる密閉容器の重量増を軽減す ることができる。

5

15

20

25

上記板状部材は、密閉容器の撮像空間側の面に対して向かい合う面の壁面を、 撮像空間側の面の壁面よりも厚くすることにより、密閉容器と一体に形成された 10 構成とすることができる。これにより、密閉容器の剛性をより高めることができ る。

上記傾斜磁場発生部は、固定手段によって密閉容器に固定し、一体化することが可能である。剛構造により剛性が高められて振動しにくい密閉容器に傾斜磁場発生部が一体化されることにより、傾斜磁場発生部の振動を抑制することができる。

上記密閉容器はそれぞれ、撮像空間側の面に設けられた第1の凹部を備える構成にすることが可能である。この場合、傾斜磁場発生部はそれぞれ、第1の凹部内に固定される。連結部は、その内部に前記撮像空間側の面からそれに対向する面へと貫通するように設けられた1以上の貫通孔を含む構成とする。貫通孔の少なくとも1つには、傾斜磁場発生部に電流を供給するための傾斜磁場用ケーブルを配置することができる。このように、第1の凹部に傾斜磁場発生部を配置することにより撮像空間の領域を広く確保することができる。密閉容器の連結部として貫通孔を用い、その中に傾斜磁場用ケーブルを配置することにより、傾斜磁場用ケーブルを撮像空間側に引き回す必要がなくなり、撮像空間を広く確保することができると共に、ケーブルの振動が密閉容器に伝達する現象を低減することが

できる。

5

15

20

上記密閉容器は、前記撮像空間側の面に向かい合う面に第2の凹部を有する構成とすることが可能であり、第2の凹部の内側には剛性補強部材を配置することができる。これにより、密閉容器を軽量化することができる。すなわち、剛性補強部材による重量増を第2の凹部により軽減することができる。

上記貫通孔の配置としては、第1の凹部の側面の近傍に配置することが可能である。

上記貫通孔の配置としては、貫通孔の少なくとも1つを、第1の凹部の略中央 に配置することも可能である。

10 上記剛性補強部材の内部には、貫通孔に通じる経路が設けられた構成にすることが可能であり、経路のうちの1つには傾斜磁場用ケーブルを配置することが可能である。

上記MR I 装置には、傾斜磁場発生部を冷却するための冷媒を循環させる手段をさらに配置することができる。その場合、傾斜磁場発生部はその内部に冷媒を通過させる手段を設けることが可能である。この場合、貫通孔のうちの少なくとも1つ、およびそれに通じる経路には、傾斜磁場発生部に冷媒を供給する配管を配置する構成とすることができる。

上記MRI装置には、撮像空間に高周波磁場を発生させるための一対の高周波磁場発生部をさらに配置することが可能である。一対の高周波磁場発生部のそれぞれは、傾斜磁場発生部よりも撮像空間側に配置する。貫通孔のうちの少なくとも1つ、ならびに、それに通じる経路には、高周波磁場発生部に電流を供給するための高周波磁場用ケーブルを配置することが可能である。

上記密閉容器の前記貫通孔を3以上設けることが可能であり、傾斜磁場用ケーブル、高周波磁場用ケーブルおよび配管は、それぞれ別々の貫通孔および別々の 25 経路に配置することができる。上記経路は、剛性補強部材の内部で合流させ、貫 通孔の数よりも少ない数の経路となって剛性補強部材の外部に通じる構成とすることが可能である。合流した経路には、経路内の傾斜磁場用ケーブルまたは高周波磁場用ケーブルが通過する空間と配管が通過する空間とを分離する仕切りを配置すること可能であり、仕切りは熱伝導性の高い材料で構成されたものを用いることができる。上記配管は、傾斜磁場用ケーブルまたは高周波磁場用ケーブルよりも鉛直下側に配置されている構成にすることが可能である。

上記貫通孔は、第1の凹部の内側に開口を有する構成とすることが可能であり、 傾斜磁場発生部は、貫通孔の開口の位置に電流受給端子を備え、傾斜磁場用ケー ブルは電流供給端子を備え、電流供給端子が電流受給端子に接続されている構成 にすることが可能である。

上記傾斜磁場用ケーブルは、貫通孔内に固定部材によって固定されている構成にすることが可能である。これにより、ケーブルから密閉容器に伝達する振動を さらに低減することができる。

上記貫通孔は、第1の凹部の内側に開口を有する構成にすることが可能であり、 15 傾斜磁場発生部は、貫通孔の開口の位置に冷媒受給端子を備え、配管は冷媒供給 端子を備え、冷媒受給端子が冷媒供給端子に接続されている構成にすることが可 能である。

上記配管、冷媒供給端子および冷媒受給端子は、導電性材料により構成することが可能であり、これらに傾斜磁場発生部に電流を供給する傾斜磁場用ケーブルを兼用させることができる。

#### 図面の簡単な説明

10

20

25

図1は、第1の実施の形態のMR I 装置の全体構成を示すブロック図である。 図2は、第1の実施の形態のMR I 装置の静磁場発生装置1の斜視図である。 図3は、第1の実施の形態のMR I 装置の下部超電導磁石101bの部分断面図 である。 図4は、第2の実施の形態のMRI装置の下部超電導磁石101bの部分断面図である。

図5 (a)は、第2の実施の形態のMRI装置の下部超電導磁石101bの下面図、図5 (b)は、下部超電導磁石の101の格子状補強部材52の部分側面図である。

5

図6は、第3の実施の形態のMRI装置の下部超電導磁石101bの下部の断面 図である。

図7は、第4の実施の形態のMRI装置の下部超電導磁石101bの部分断面図である。

10 図8は、第5の実施の形態のMRI装置の下部超電導磁石101bの下部の断面 図である。

図9は、第6の実施の形態のMRI装置の下部超電導磁石101bの下部の断面 図である。

図10は、第6の実施の形態のMRI装置の下部超電導磁石101bの下部の断 15 面図である。

図11は、第6の実施の形態のMRI装置の板状補強部材51の開口71bの正面図である。

図12は、第7の実施の形態のMRI装置の静磁場発生装置1の断面図である。

図13は、第8の実施の形態の磁気共鳴イメージング装置の静磁場発生装置を示 20 す断面図である。

図14は、第8の実施の形態のケーブルの固定構造(固定剤方式)を示す断面図である。

図15は、第8の実施の形態のケーブルの固定構造(クッション方式)を示す断面図である。

25 図16は、第8の実施の形態のケーブルの固定構造(ガイド・レール方式)を示

す断面図である。

図17は、第8の実施の形態の端子接続構造を示す断面図である。

図18は、第8の実施の形態の図17の上面図である。

図19は、第8の実施の形態の端子接続構造を示す上面図である。

5 図20は、第9の実施の形態の磁気共鳴イメージング装置の静磁場発生装置の断 面図である。

図21は、第9の実施の形態の端子接続構造を示す断面図である。

図22は、第9の実施の形態の端子接続構造を示す断面図である。

図23は、第10の実施の形態の配管の端子接続構造を示す断面図である。

10 図24は、第10の実施の形態のロック式のコネクタを用いた配管の接続構造を 示す断面図である。

図25は、第10の実施の形態のゴム製のチューブを用いた配管の接続構造を示す断面図である。

図26は、第10の実施の形態のコネクタを用いた配管の接続構造を示す図であ 15 る。

図27は、第10の実施の形態の凹部3の略中央での配管を接続する構造を示す 断面図である。

図28は、第11の実施の形態の静磁場発生装置の断面図である。

図29 (a) は、第12の実施の形態の下側超電導磁石101bの断面図である 20 り、図29 (b) は、図29 (a) の超電導磁石101bに凹部3と貫通孔4を 設けた構成を示す断面図である。

図30は、第13の実施の形態の下側超電導磁石101bの断面図である。

図31(a)は、第14の実施の形態の下側超電導磁石101bの断面図であり、

図31(b)は、図31(a)の一部を拡大した断面図と、ナットとネジの斜視

25 図である。

図32は、第14の実施の形態の台座を取り付けて傾斜磁場コイルをボルト固定 する構造を示す断面図である。

図33は、本発明に第1の実施の形態のMRI装置の全体構成を示す斜視図であ る。

#### 5 発明を実施するための最良の形態

本発明の一実施の形態の磁気共鳴イメージング装置について図面を用いて説明 する。

## (第1の実施の形態)

25

第1の実施の形態のMRI装置は、図1および図33にその全体図を示したよ 10 うに、静磁場発生装置1と、傾斜磁場コイル21と、高周波照射コイル22と、 被検体129を搭載するベッド131と、髙周波受信コイル132とを有してい る。これらの他に制御・演算系として、傾斜磁場電源135、高周波装置134、 制御装置137、演算装置128、入力装置141および表示装置130を含ん でいる。また、図1に示すように、傾斜磁場コイル21に冷却水等の冷媒を供給 15 する熱交換器4001およびポンプ4002も有している。

静磁場発生装置1は、図2、図3および図33に示したように、上下に対向し て配置された一対の超電導磁石101a、101bと、それらを連結する2本の 連結柱6とを有する。一対の超電導磁石101a、101bは、その間の空間に 強く均一な静磁場領域(撮像空間)9を生じさせる。磁場の方向は、2方向であ 20 る。ベッド131は、被検体129を搭載し、撮像部位を均一静磁場領域9に配 置する。傾斜磁場コイル21および髙周波照射コイル22は、図1に示すように 超電導磁石101a、101bの被検体129側(対向面側)に配置されている。 高周波照射コイル22は、ラーモア周波数に等しい周波数の高周波磁場パルスを 撮像部位に照射する。これにより、被検体129の原子核スピンは励起され、N MR信号を放出する。撮像部位の近傍に配置された受信コイル132は、放出さ

れたNMR信号を検出する。傾斜磁場コイル21は、NMR信号に位置情報を付加するために、X, Y, Zの3軸方向について傾斜磁場を均一静磁場領域9に印加する。

受信コイル32によって受信されたNMR信号は、高周波装置134によって 検出され、演算装置128に受け渡され、画像再構成演算等が行われる。再構成 された画像は、表示装置130に出力され表示される。また、高周波装置134 は、受信コイル132の受信信号の検出の他に、高周波照射コイル22に高周波 磁場パルスを発生させるための高周波電力の供給も行う。傾斜磁場電源135は、 傾斜磁場コイル21へ電流を供給し、所定の傾斜磁場を発生させる。制御装置1 37は、傾斜磁場電源135および高周波装置134の動作を制御する。これに より、入力装置141を介してオペレータから指示を受けた所定の撮像パルスシ ーケンスを実行させる。また、演算装置128の演算処理を制御することにより、 オペレータの所望の画像を再構成させる。

5

10

つぎに、超電導磁石101a、101bの詳しい構造を、図3の超電導磁石1 01bの断面図を参照して説明する。超電導磁石101a、101bは、クライオ容器2と、その内部に収容された超電導コイル群11とを有する。クライオ容器2は、冷媒のヘリウムが充填された冷媒槽33と、その外側に所定の間隔を開けて固定された真空容器31とを含む。超電導コイル群11は、冷媒槽33の内部に配設されている。冷媒槽33と真空容器31との間に空間は所定の真空度に20 減圧されている。また、冷媒槽33と真空容器31との間の真空空間には、冷媒槽33を包み込むように熱輻射シールド層(図示せず)が配置されている。このような構造により、超電導コイル群11の温度を超電導転移温度以下に保持している。なお、冷媒槽33および真空容器31は、ステンレス製またはガラス繊維強化プラスチック(GFRP: Glass Fiber Reinforced Plastics)製のものを用いることができる。

超電導コイル群11は、アクティブシールド方式で漏洩磁場を防止する構成であり、静磁場領域9を形成する磁場を発生する超電導コイル12と、漏洩磁場防止のための磁場を発生するシールド用超電導コイル13と、静磁場均一度の向上のための補正用超電導コイル14とを含んでいる。シールド用超電導コイル13と補正用超電導コイル14を強磁性体に置き換えることも可能である。

5

10

15

クライオ容器2の外形は、円柱形状であるが、均一静磁場領域9側の面(対向面)25の壁面には、図2、図3に示したように凹部3が設けられている。すなわち、対向面25を構成する真空容器31の壁面31aおよび冷媒槽33の壁面33aは、凹部3の形状に窪んでいる。傾斜磁場コイル21は、凹部3の内側に配置された固定部15によって支持され、かつ、クライオ容器2に固定されている。固定部15による傾斜磁場コイル21の固定方法としては、接着剤等による固着やボルト等による締結等を用いることができる。高周波照射コイル22は、凹部3内であって傾斜磁場コイル21のより撮像空間9側に配置されている。また、必要に応じて静磁場を補正するためのシムコイルを凹部3内に配置することもできる。このように、凹部3内に傾斜磁場コイル21と高周波照射コイル22とシムコイル等を配置することにより、上下の超電導磁石101a、101bの間の空間に、傾斜磁場コイル21と高周波照射コイル22とシムコイル等を配置することにより、上下の超電導磁石101a、101bの間の空間に、傾斜磁場コイル21と高周波照射コイル22等が突出しない。これにより、上下の超電導磁石101a、101bの間の空間を広くできるため、被検体129に開放感を与えることができる。

20 また、図2に示したように、超電導磁石101a, 101bのそれぞれのクライオ容器2は、対向面25とは逆側の面(反対向面)26に構成補強部材が固定されている。ここでは構成補強部材として、剛性の大きな材料で構成された厚板状補強部材51を用いている。厚板状補強部材51の材料は、剛性の大きな材料であればよく、例えば金属やセラミックスを用いることができる。厚板状補強部25 材51の厚さは、厚いほど大きな剛性が得られるので望ましいが、厚くなるほど

重量も大きくなり、配置スペースも必要となるとなるため、これらを勘案して適切な厚さのものを用いる。厚板状補強部材51の固定方法としては、例えば、クライオ容器2の反対向面26の全面または一部へ溶接または接着等により強固に固着する方法や、多数本のボルトで締結する方法を用いることができる。これにより、厚板状補強部材51は、クライオ容器2の反対向面26の剛性を補強している。

5

10

15

20

25

また、クライオ容器 2 には、反対向面 2 6 から対向面 2 5 へと貫通する複数の 貫通孔 4 が設けられている。貫通孔 4 の壁面は、冷媒槽 3 3 を延長した壁面 3 3 bと真空容器 3 1 を延長した壁面 3 1 b の二重構造になっており、断熱構造を維持している。これら貫通孔 4 の壁面は、反対向面 2 6 に対して対向面 2 5 を支持する支柱として作用する。反対向面 2 6 は、厚板状補強部材 5 1 によって剛性が高められているため、これに一端が固定された貫通孔 4 の壁面が、対向面 2 5 を複数箇所で支持することにより、クライオ容器 2 の対向面 2 5 の剛性を高めることができる。

超電導磁石101a、101bは、強度の大きな静磁場領域9を効率よく発生させる必要があるため、クライオ容器2の対向面25の壁面31a,33aの間隔および厚さをなるべく薄くし、超電導コイル12を静磁場領域9に近接させることが望まれる。このため、クライオ容器2の対向面25の剛性を向上させることは容易ではないが、本実施の形態では反対向面26側に厚板状補強部材51を配置して剛性を高め、反対向面26から対向面25~と貫通する貫通孔4を設けることにより、対向面25の厚さを厚くすることなく剛性を高めることができる。また、対向面25の凹部3に固定されている傾斜磁場コイル21には、傾斜磁場電源135から撮像パルスシーケンスに合わせたパルス電流が供給されるため、パルス状のローレンツ力が生じ、振動が発生することが知られている。この振動は、傾斜磁場コイル21が固定されているクライオ容器2の壁面31a、33a

に伝搬するが、複数箇所に配置された貫通孔4の壁面31b、33bが支柱として支えることにより、対向面25を構成する壁面31a、33aの振動を効果的に低減することができる。

なお、貫通孔4の数および配置は、傾斜磁場電源135に生じる振動周波数や クライオ容器2の固有振動数、厚板状補強部材51の重量や厚さ等を考慮してシ ミュレーション等により、効果的に振動が抑制される数および位置を求め、それ により決定する。

5

10

15

20

25

一方、凹部3に配置する高周波照射コイル22および傾斜磁場コイル21、ならびに必要に応じて配置するシムコイルには、高周波装置134および傾斜磁場電源135等から電流を供給する配線(ケーブル)8を接続する必要がある。また、傾斜磁場コイル21には、強度の大きな傾斜磁場を得るために短時間に大電流を供給がされるため、冷却管を接続し、熱交換器4001によって冷却された冷媒(例えば水)をポンプ4002から供給し、コイル導体に生じるジュール熱を冷却する必要がある。よって、ケーブル8を4本~6本と冷却管2本を外部から凹部3の内側に引き込む必要がある。ケーブル8や冷却管の外径は、一般的なMRI装置ではφ10mm~30mm程度であるため、6~10本となると、かなりのスペースが必要であり、クライオ容器2の凹部3の辺縁部を乗り越えさせるルートで配設すると、超電導磁石101a、101bの間の空間を狭めてしまう。また、クライオ容器2の凹部3の辺縁部には、静磁場を効果的に発生させるために超電導コイル12が近接して配置されるため、辺縁部に切り欠きを設けることはできない。

そこで、本実施の形態では、ケーブル8および冷却管を貫通孔4を通して、外部から凹部3内へ引き込む構成を用いる。すなわち、クライオ容器2の貫通孔4と連続し、外部まで通じる貫通孔71を厚板状補強部材51に設け、貫通孔4および貫通孔71を配線・配管路として用いる。図3の例では、厚板状補強部材5

•

10

20

25

1のクライオ容器 2 側の面に、貫通孔 4 から外周面まで通じる構形状の貫通孔 7 1を設けている。貫通孔 7 の開口 7 1 a は、厚板状補強部材 5 1 の外周面に設けられている。ケーブル 8 は、開口 7 1 a から厚板状補強部材 5 1 の貫通孔 7 1 に引き込まれ、クライオ容器 2 の貫通孔 4 を通されて凹部 3 内に引き込まれ、傾斜磁場コイル 2 1 および高周波照射コイル 2 2 等に接続されている。また、図示していないが冷却管も別の貫通孔 4 および貫通孔 7 1 を通すことによって、凹部 3 内に引き込み、傾斜磁場コイル 2 1 に接続している。

これにより、ケーブル8および冷却管を、2つの超電導磁石101a、101 bとの間の空間を通すことなく、傾斜磁場コイル21および高周波照射コイル2 2等に接続することができるため、2つの超電導磁石101a、101bの間の 空間を広く維持でき、被検者129に開放感を与えることができる。また、術者 が被検者129~アクセスするのも容易になる。

上述してきたように、本実施の形態の構成によれば、クライオ容器2の凹部3に傾斜磁場コイル21および高周波照射コイル22等を配置でき、かつ、ケーブル8および冷却管をクライオ容器2の貫通孔4を通して凹部3内に引き込むことができるため、2つの超電導磁石101a、101bの間の空間を広く維持でき、被検者129に開放感を与えることができる。しかも、貫通孔4の壁面31b,33bが対向面25を支持する支柱として作用するため、傾斜磁場コイル21から伝搬する振動によって対向面25に振動が生じるのを抑制することができる。よって、ケーブル8等の引き回しのために対向面25の辺縁部を切り欠いたり、振動抑制のために対向面25を厚くしたりする必要がないため、超電導コイル12による静磁場領域9の発生に影響を与えることなく、開放性の維持の効果と、振動抑制の効果とを同時に得ることができる。

厚板状補強部材 5 1 は、例えば、厚さ数十 c mにすることができ、その材質と してはステンレス等を用いることができる。クライオ容器 2 の貫通孔 4 の数は、 3本以上にすることができ、それらを点対称な位置に配置することができる。また、貫通孔4の直径は、クライオ容器2の直径に対して約15%以下にすることが望ましい。その理由は、貫通孔4の直径が大きくなると、クライオ容器2の構造強度は高まるが、表面積が大きくなるために、冷媒槽33への熱浸入量が増加するためである。具体的には、本実施の形態では、貫通孔4は、3本としており、その直径は、100mm程度にしている。クライオ容器2の直径は、一般的なMRI装置と同じく2m弱である。貫通孔4の直径が100mm程度であれば、貫通孔4を設けることより増加するクライオ容器2の壁面面積の割合はわずかであり、クライオ容器2の断熱効果はほとんど低減しない。また、100mm程度の径があれば、貫通孔4にケーブル8や冷却管をそれぞれ通すことが可能である。

5

10

25

上述の実施の形態では、厚板状補強部材51とクライオ容器2とを別部材とし、 固着等の手段により両者を固定する構成であったが、クライオ容器2の反対向面 26側の壁面(底面)を厚板状補強部材51と同様の厚さにすることにより、厚 板状補強部材51とクライオ容器2とを一体にすることもできる。

15 また、図3の例では、厚板状補強部材51に設けた貫通孔71から外周面にケーブル8等を引き出しているが、厚板状補強部材51を厚さ方向に貫通する貫通孔71を設け、厚板状補強部材51の裏面からケーブル8および冷却管を引き出す構成にすることももちろん可能である。この場合、下側の超電導磁石101bについては、厚板状補強部材51に脚部を設け、床面との間に空間を確保することにより、ケーブル8および冷却管を容易に引き出すことができる。

貫通孔4、71の壁面と、ケーブル8または冷却管との間に、クッション部材を配置したり、接着剤を充填することにより、ケーブル8または冷却管を貫通孔4、71の壁面と固定することも可能である。これにより、傾斜磁場コイル21の振動がケーブル8や冷却管を伝わって超電導磁石101a、101bに伝導するのを低減することができる。

また、本実施の形態では、液体ヘリウム温度まで冷却するクライオ容器2であるため、貫通孔4の壁面を真空容器31の壁面31bと冷媒槽33の壁面33bの二重構造にしているが、超電導コイル群11を液体ヘリウム温度まで冷却する必要がない場合には、内周側の冷媒槽33の壁面33bを設けず、一重構造にすることも可能である。

なお、一般に超電導磁石から傾斜磁場電源135や高周波装置134へのケーブルは、床面近くに配置されるので、上部超電導磁石101aに接続するケーブル8および冷却管は、連結柱6の側面を這わせて上部超電導磁石101aまで到達させるように配置することができる。

本発明の第2の実施の形態のMRI装置について、図4および図5(a).(b)

## 10 (第2の実施の形態)

.

5

第3の実施の形態のMRI装置について、図6を用いて説明する。第3の実施 25 の形態のMRI装置は、第1の実施の形態と同様に、補強部材として厚板状補強 部材51を用いるものであるが、厚板状補強部材51は複数の部材に分割されたものを用いる。図5の例では、円形の厚板状補強部材51は、2つの半円状の部材51a、51bに予め分割されており、部材51aと部材51bとを、クライオ容器2の貫通孔4の開口を挟んで空隙73を開けて配置している。これにより、空隙73をケーブル8および冷却管を配置する経路として用いることができる。よって、図3のように厚板状補強部材51のように貫通孔71を形成する必要がなく、厚板状補強部材51の製造が容易になるという利点がある。

ただし、図6に示した例では、空隙73が厚板状補強部材51の中央を横切るように配置しているが、この配置に限らず、クライオ容器2の振動周波数や厚板 状補強部材51の固有振動数等を考慮して、振動抑制の観点から最適な位置に空 隙73を配置するように設計することが望ましい。

## (第4の実施の形態)

5

10

15

20

25

第4の実施の形態のMRI装置について、図7を用いて説明する。第4の実施の形態のMRI装置は、クライオ容器2の対向面25側に設けた凹部3のみならず反対向面26側にも凹部104を設けた構造である。反対向面26には、格子状補強部材52を配置している。格子状補強部材52は、凹部104の内部にも配置されている。

一般的に、アクティブシールド方式の超電導コイル群11は、第1の実施の形態で既に述べたように、均一静磁場領域9に近い対向面25側に超電導コイル12が配置され、補正用超電導コイル14も対向面25側に配置される。そして、反対向面26側にシールド用超電導コイル13が配置される。このため、反対向面26の中央部には、コイルは配置されていないため、この部分に凹部104を設けることができる。これにより、凹部104内にも格子状補強部材52を配置することができるため、超電導磁石101a,101bの厚さを薄くすることが可能である。よって、凹部104がない図4に示した構成と同じ剛性を、薄い超

電導磁石101a、101bによって得ることができる。これにより、コンパクトな超電導磁石101a、101bを提供することが可能である。

また、凹部104の高さを大きく取ることにより、ケーブル8や配管を曲げる際に大きな曲率半径にすることが可能になる。よって、大電流が必要な傾斜磁場コイル21のケーブル8等、外径の太いケーブルも容易に配設することが可能になる。

なお、図7の格子状補強部材52に代えて、図2の構造の厚板状補強部材51 や図6の構造の厚板状補強部材51を配置することも可能である。

## (第5の実施の形態)

5

第5の実施の形態のMRI装置について、図8を用いて説明する。第5の実施の形態のMRI装置は、クライオ容器2に3以上の貫通孔4を設け、3つの貫通孔4にそれぞれ連結する3つの貫通孔71を厚板状補強部材51に放射状に設けている。3つの貫通孔71には、それぞれ傾斜磁場コイル21へのケーブル81と、高周波照射コイル22へのケーブル82と、傾斜磁場コイル21への冷却管83とを通している。このように配置することにより、ケーブル81とケーブル82とが近接することがないので、大電流が流れる傾斜磁場コイル21へのケーブル81から生じる誘導磁場によって、高周波照射コイル22へのケーブル82に流れる信号が影響を受けるのを防止することができる。また、冷却管83が配置される貫通孔71が、ケーブル81,82がそれぞれ配置される貫通孔71と
は別であるため、万一、冷却管83に漏水が発生した場合であっても、ケーブル81、82が水で濡れる恐れがない。

また、3つの貫通孔71を放射状に配置したことにより、厚板状補強部材51の剛性の対称性を高めることができるため、傾斜磁場コイル21に発生させる傾斜磁場の軸によって傾斜磁場コイル21の振動挙動が変化した場合であっても、

25 軸方向に関わらず振動抑制が可能である。

また、図8に示した構成では、クライオ容器2に3以上の貫通孔4を設け、3 つの貫通孔4からそれぞれケーブル81、82および冷却管83を引き出しているが、貫通孔4を中央部に1つのみ設け、この1つの貫通孔4からケーブル81,82および冷却管83を引き出すことも可能である。この場合、厚板状補強部材51の放射状の3つの貫通孔71を中央部で連結した構成とする。ケーブルが近接した部分には、ケーブル81,82、冷却管83の間をそれぞれ電気的に仕切る分離板等を配置することが望ましい。

### (第6の実施の形態)

5

20

25

第6の実施の形態のMRI装置について、図9、図10、図11を用いて説明 する。第6の実施の形態のMRI装置は、図9に示したようにクライオ容器2に 少なくとも3つの貫通孔4を設け、厚板状補強部材51には3つの貫通孔4にそれぞれ連結する3つの貫通孔71を設けている。この3つの貫通孔71は、厚板 状補強部材51の途中の合流点71cにおいて合流し、1本の径の大きな貫通孔 71dになっている。径の大きな貫通孔71dの開口71bは、厚板状補強部材 51の外周面に設けられている。また、径の大きな貫通孔71dの内部には、内 部空間を3つに分割するための板状もしくは筒状の仕切り86が配置されている。

傾斜磁場コイル21へのケーブル81と、高周波照射コイル22へのケーブル82と、傾斜磁場コイル21への冷却管83はいずれも、開口71bから厚板状補強部材51内の径の大きな貫通孔71dに引き込まれ、仕切り86によって分離された3つの空間をそれぞれ通り、合流点71cにおいて3つの貫通孔71に分岐し、クライオ容器2の別々の貫通孔4を通って、凹部3内に引き込まれる。このような構造により、一カ所の開口71bにおいて、ケーブル81、82と冷却管83とをすべて管理することができるため、管理が容易になるという利点がある。

また、本実施の形態では、図11に示したように、径の大きな貫通孔71dの

内部において、仕切り86で分離された3つの空間のうち鉛直上側に位置する2つの空間をケーブル81とケーブル82とがそれぞれ通り、鉛直下側に位置する1つの空間を冷却管83が通るようにしている。これにより、万一、冷却管83に水漏れが生じた場合であっても、ケーブル81、82が濡れる恐れがないようにしている。

さらに、図11のように、冷却管83は、傾斜磁場コイル21へのケーブル8 1の下側の空間を通過するように配置されている。このように冷却管83を配置 することにより、大電流が流れるケーブル81から生じるジュール熱を冷却管8 3によって冷却することができる。なお、ケーブル81の構造としては、傾斜磁 10 場コイル21のX, Y, Zコイルへのそれぞれの給電線6本を束に配線するので はなく、図11のように一列に並べて配線することにより、冷却効率を高めるこ とができる。仕切り86の材質は、銅やアルミ等の熱伝導性が高い金属にするこ とにより、冷却効率が高まる。この仕切り86は、磁気シールドとして作用する ため、傾斜磁場コイル21へのケーブル81から生じる誘導電磁波がケーブル8 2~影響を与えるのを防止する効果も得られる。

### (第7の実施の形態)

5

20

25

第7の実施の形態のMRI装置について、図12を用いて説明する。第7の実施の形態のMRI装置は、図12に示したようにクライオ容器2の反対向面26の壁面(底面)を厚くすることにより、厚板状補強部材54を一体に形成している。この厚板状補強部材54は、貫通孔4よりも外周側のドーナツ状の領域のみ配置している。貫通孔4よりも中心側の領域には、格子状補強部材56を配置している。これにより、加工が容易な構造でありながら、クライオ容器2の反対向面26の剛性を高めている。ただし、図12においては、連結柱6を省略している。

格子状補強部材56は、開口の位置が貫通孔4の位置と一致するよう配置され

ている。ケーブル81,82および冷却管83は、格子状補強部材54の開口および貫通孔4を通って、凹部3内に引き込まれている。また、図12のように、下側の超電導磁石101bの下に脚部55を配置し、床面57との間に空間を作ることにより、下側の超電導磁石101bへのケーブル81、82および冷却管83の外周面への引き回しを容易にすることができる。

5

10

15

20

25

上述してきた第1から第7の実施の形態では、上側の超電導磁石101aと下側の超電導磁石101bで、クライオ容器2の補強構造を同じにしている。しかしながら、上下の超電導磁石101a、101bで振動に対する応答は当然異なるので、上側は格子状補強部材52を採用し、下側は板状補強部材51を採用するなど、上下の超電導磁石101a、101bで異なる補強構造を用いることもできる。また、上下の超電導磁石101a、101bで、補強部材の寸法や材質を異ならせることも可能である。一般に重量物を超電導磁石101aの上部に配置すると低い周波数の共振を生じやすくなるため、図12の実施の形態のように、厚板状補強部材51の厚さを、下側の超電導磁石101bと比較して、上側の超電導磁石101aの方が薄くなるようにすることができる。

また、第1~第7の実施の形態では、クライオ容器2に対して傾斜磁場コイル21を固定部15によって固定しているが、後述する第11~第14の実施の形態で示した構造を用いてクライオ容器2と傾斜磁場コイル21とを強固に固定し、一体化することも可能である。これにより、クライオ容器2と傾斜磁場コイル21の全体の剛性が向上するので、クライオ容器2および傾斜磁場コイル21全体の振動を低減することができる。

さらに第1~第7の実施の形態において、傾斜磁場コイル21とケーブル8との接続部の構造、または、傾斜磁場コイル21と冷却管83との接続部の構造として、後述の第8~第10に示した構造を用いることが可能である。これにより傾斜磁場コイルとケーブル8または冷却管63との接続を容易に行うことができ、

製造効率およびメンテナンス作業の効率を向上させることができる。

## (第8の実施の形態)

5

10

15

20

25

次に、本発明に係る第8の実施の形態を図13に基づいて説明する。第8の実施の形態のMRI装置は、第1の実施の形態と同様の構成であるが、超電導磁石101a,101bには厚板状補強部材51、54および格子状補強部材52、56は備えられていない。

超電導磁石101a、101bのクライオ容器2には、中央の凹部3の側面付近、つまり傾斜磁場コイル21側面付近に、少なくとも1以上(図13では両側に2つ)の貫通孔4が対向面25側から反対向面26側を結んで設けられている。 貫通孔4の断面形状は、円、四角形、楕円などでいずれでも良い。

図14に示すように傾斜磁場コイル21及び高周波磁場コイル22のケーブル8は、貫通孔4に固定される。すなわち、超電導磁石101a、101bの組立時に、貫通孔4にケーブル8を通し、液ダメ用の栓207を穴の下方に配置し、上方から固定剤(例えば樹脂、発泡剤)208を流し込んで硬化させることによりケーブル8を貫通孔4に固定している。液ダメ用の栓207は、樹脂、またはシリコンゴムなどの高分子材料でもよく、気密性の高いものが良い。

また図15に示すように、あらかじめ外径が貫通孔4の穴形状に加工されたクッション材(例えばコルク、緩衝材)209にケーブル8を固定し、貫通孔4に挿入しても良い。クッション材209の貫通孔4への固定は、あらかじめクッション材209外表面に接着剤を塗っておくか、または、貫通孔4への挿入後に接着剤を流し込む方法によって行うことができる。

また図16に示すように、ケーブル8に棒状のガイド221を固定しておき、 貫通孔4には、ガイド221を案内するレール222を取り付ける構成にすることも可能である。これにより、ケーブル8を固定したガイド221をレール22 2に沿って案内し、所定の位置でガイド221を固定する構成にすることも可能 である。

5

10

15

20

図17に示すように、ケーブル8は、傾斜磁場コイル21に取り付けられた電流受給端子211に接続される。図18は図17を上方から見た図である。ケーブル8の先端には電流供給端子210が取り付けられている。端子211は傾斜磁場コイルから出ている電流受給端子である。電流受給端子211が電流供給端子210に重なるように、上方から傾斜磁場コイル21をクライオ容器2に搭載し、ボルト212によって端子210,211を締結することにより、傾斜磁場コイル21とケーブル8とを接続することができる。これにより、ボルト212の締結は、凹部3の上方からアクセスできるため、視認性が良く、締結作業を容易に行うことができる。また、ボルト212を外すだけでケーブル8と傾斜磁場コイル21とを分離できるので、傾斜磁場コイル21の取り外しも容易に行うことができる。

また、端子210,211は図17の様にボルト212で締結せずに、コネクタを用いて電気的に接触させる構成にすることも可能である。図19に電流供給端子210としてコネクタ213、電流受給端子211としてコネクタ214を用いた例を示す。コネクタ213,214としては、例えば、マルチコンタクト社製の商品名「フォークプラグ」を用いることが可能である。

以上が第8の実施の形態であるが、別の態様として、予め傾斜磁場コイル21にケーブル8を取り付けておき、傾斜磁場コイル21を超電導磁石101a、101bに取り付ける際に、ケーブル8を貫通孔4に固定する構成にすることもできる。その場合、傾斜磁場コイル21に取り付けられているケーブル8は、クライオ容器2に傾斜磁場コイル21を取り付ける際に貫通孔4を通す。その方法としては、例えば、ケーブル8に棒状等のガイド221となるものを仮固定し、ガイド221を貫通孔4に設けたレール222に通す方法を用いることができる。

25 次に、貫通孔4の下部に液ダメ用の栓207を配置し、上方より固定剤208を

流し込み、硬化させる。

5

10

15

25

または、レール222を用いずにガイド221のみで貫通孔4を通し、貫通孔4の下方に液ダメ用の栓207を配置し、上方より固定剤208を流し込み硬化させても良い。また、ガイド221の先端にケーブル8を仮固定し、貫通孔4を通す際のガイドとして用いた後はガイド221を取り外しても良い。

第8の実施の形態では、クライオ容器 2 に設けられた貫通孔 4 の壁面が支柱として作用するため、クライオ容器 2 全体の剛性を高めることができる。これにより、超電導磁石 1 0 1 a , 1 0 1 b の振動を低減することが可能である。また、ケーブル 8 と貫通孔 4 の壁面との間の空間をクッション材 2 0 9 や固定剤 2 0 8 で充填し、ケーブル 8 を固定しているため、傾斜磁場コイル 2 1 の振動がケーブル 8 を介して超電導磁石 1 0 1 a , 1 0 1 b に伝導するのを低減することができる。また、貫通孔 4 にケーブル 8 を通す際に、端子 2 1 0 , 2 1 1 等を用いることにより、接続の作業が容易になるという効果も得られる。

なお、クライオ容器 2 に対して、第 1 ~第 7 の実施の形態の厚板状補強部材 5 1,5 4 や格子状補強部材 5 2,5 6 を固定することももちろん可能であり、その場合、クライオ容器 2 の剛性をさらに向上させることができるため、超電導磁石 1 0 1 a、1 0 1 b の剛性をいっそう低減することができる。

#### (第9の実施の形態)

次に、本発明に係る第9の実施の形態を図20に基づいて説明する。本実施の 20 形態も第8の実施の形態と同様に、超電導磁石101a, 101bには、厚板状 補強部材51等および格子状補強部材52等は備えられていない。

図20の超電導磁石101a、101bのクライオ容器2には、中央の凹部3の中心部に少なくとも1以上(図20では1つ)の貫通孔4が対向面25側から反対向面26側を結んで設けられている。接続端子以外の構成は、第8の実施の形態の図13の構造と同じである。

図21に、本実施の形態のケーブル8と傾斜磁場コイル21との接続構造を示す。端子215は、ケーブル8の先に取り付けられた電流供給端子であり、窪み215aを有している。ここでは、この窪み215aの断面形状を円形としているが、特に円形である必要はなく多角形でも良い。端子216は、傾斜磁場コイル21に取り付けられた電流受給端子であり、端子215の円形の窪み215aに挿入される突起216aを有している。電流受給端子216の突起216aを電流供給端子215の窪み215aに挿入することにより、傾斜磁場コイル21をケーブル8に接続することができる。このようにすることで、超電導磁石101a、101bの中央部にケーブル8を接続することができ、取り外しも容易になる。この様な端子構造の具体例として、マルチコンタクト社製の商品名「B10Nソケット」と「S10Nプラグ」を用いることができる。さらには、着脱可能なロック式のコネクタ(例えば、マルチコネクタ社製の商品名「B10ARーNソケット」と「S10AR—Nプラグ」)または図19に示すようなコネクタで垂直方向に接続可能なものを用いても良い。

5

10

25

第9実施の形態の別の態様として、事前に傾斜磁場コイル21にケーブル8を取り付けておき、傾斜磁場コイル21を超電導磁石101a、101bに取り付ける際に、ケーブル8を貫通孔4に固定する構成にすることもできる。その場合、傾斜磁場コイル21に予め接続されているケーブル8は、傾斜磁場コイル21を超電導磁石101a、101bに取り付ける際に貫通孔4を通す。その方法としては、図22に示すように、あらかじめ外径が貫通孔4の形状に加工されたクッション材217をケーブル8に固定し、クッション材217を貫通孔4に挿入する方法を用いることができる。クッション材117は、クッション材217外表面にあらかじめ塗布しておいた接着剤によって貫通孔4に固定することができる。以上は、傾斜磁場コイル21へのケーブル8について説明したが、高周波磁場

コイル22やシムコイルへのケーブル8の接続も同様に行うことができる。その

際複数の貫通孔4を設けて個別に、或いは、グループ分けしたケーブル8をそれ ぞれ貫通孔4に通しても良い。或いは、全ての必要なケーブル8を束ねて一つに まとめた状態で貫通孔4に固定することができる。

## (第10の実施の形態)

15

5 次に、第10の実施の形態として傾斜磁場コイル21を冷却する冷媒を供給するための配管2208の接続構造について図23を用いて説明する。この構造は、単独で、または、第8および第9の実施の形態で説明したケーブル8の接続構造と組み合わせて用いることができる。

図23には、傾斜磁場コイル21側面部にて、配管2208と傾斜磁場コイル 21とを端子2101、2100によって接続する構造を示す。端子2100は、配管2208の先に取り付けた冷媒供給端子であり、端子2101は傾斜磁場コイル21に取り付けられた冷媒受給端子である。

この配管2208及び端子2100、2101には、中空の貫通孔2208a が設けられている。配管2208および端子2100、2101の断面形状は四 角形でも円でも良い。冷媒供給端子2100の先端部突起2101aは、冷媒受 給端子2101に設けられた窪み2100aに挿入される。この端子2100、 2101として、図24のような着脱可能なロック式のコネクタ2102を用い ることにより着脱可能な構造にすることができる。

または、図25のように、配管2208としてゴム製のチューブ2105を用 20 いた場合は、冷媒供給端子2100を省略し、固定用バンド2103をネジ2104で締め付けることにより配管2208を固定しても良い。この様な端子2101とバンド2103の例としてストーブリ社製の商品名「クイックリリースカップリング」を用いることができる。

また、冷媒供給端子2100、及び冷媒受給端子2101として非磁性の金属 25 材料(真鍮、ステンレスなど)製のものを用いた場合は、ろう付けにより両者を 固定しても良い。または、図26のように、ナット2106を回転させることにより配管2208と端子2100、2101とを固定するスウェージロック社製のコネクタを用いても良い。

以上のように構成することにより、傾斜磁場コイル21の外部で前記冷媒を冷却し、配管2208内に冷媒(液体、または気体)を循環させことにより、傾斜磁場コイル21を冷却できる。さらには、この配管2208及び端子2100、2101として導電性材料のものを用いる場合には、傾斜磁場電源135からの電流を配管2208に給電することにより、配管2208にケーブル8の機能を兼用させ、傾斜磁場コイル21に電流を供給することもできる。

5

15

20

25

10 以上は、傾斜磁場コイル21側面部にて、配管2208を接続する場合の構造 を説明したが、図27のように、傾斜磁場コイル21の中央部において接続する 場合にも適用できる。

第8~第10の実施の形態によれば、MRI装置において、開放性を損なうことがなく、傾斜磁場コイル、高周波磁場コイル、シムコイルへの電流供給とエコー信号の受信を行うためのケーブル8および傾斜磁場コイルを冷却する冷媒を供給するための配管の固定と接続が共に容易にでき、また、メンテナンス時の傾斜磁場コイル、高周波磁場コイル、シムコイルの着脱が容易にできるようになる。

また、超電導磁石101a、101bのクライオ容器2に設けた貫通孔4の支柱としての作用により、クライオ容器2の剛性を高めることができるため、傾斜磁場コイル21の振動により超電導磁石101a、101bが振動するのを抑制することができる。しかも、ケーブル8および配管2208と貫通孔4の内壁に対してクッション材217または固定剤208で固定することにより、ケーブル8および配管2208を介して傾斜磁場コイル21の振動が超電導磁石101a、101bに伝導するのを低減することができる。これにより、超電導磁石101

a、101bの振動を低減することができる。

なお、第8~第10の実施の形態の構成に加えて、第1~第7の実施の形態の厚板状補強部材51、54や格子状補強部材52、56の構成補強部材を固定することももちろん可能である。この場合、クライオ容器2の剛性をさらに向上させることができるため、超電導磁石101a、101bの剛性をいっそう低減することができる。

#### (第11の実施の形態)

5

10

15

第11の実施の形態は、剛性向上構造を有して強固に形成された超電導磁石101a、101bに傾斜磁場コイル21を堅固に固定することにより、傾斜磁場コイル21の振動振幅を低減する。その結果、超電導磁石101a、101bの振動振幅も抑制する。同時に、振動による騒音の発生も抑制するものである。超電導磁石101a,101bの構造は、第1の実施の形態と同様であるが、厚板状補強部材51等は備えられていない。

第11の実施の形態を図28を用いて説明する。傾斜磁場コイル21は、超電導磁石101a,101bのクライオ容器の対向面25に固定部材3203により固定される。傾斜磁場コイル21の重量は構造・材質によってかなり変化するが、一般には30~400kg程度と比較的重い。本実施形態においては、クライオ容器2に傾斜磁場コイル21を堅固に固定することにより、傾斜磁場コイル21の振動振幅を低減するものである。その結果、超電導磁石101a,101bの振動振幅が抑制されると共に、騒音の発生も抑制される。

20 即ち、傾斜磁場コイル21とクライオ容器2とを堅固に固定して一体化することにより、一体化していない場合と比較して、トータルでの剛性を高めることができる。この結果、同一強度のローレンツ力が作用した場合には、一体化していない場合と比較して、振動振幅を小さく押さえることが可能となる。しかも、本実施形態においては、トータルの剛性を向上するために、傾斜磁場コイル21の25 対向面325側にヤング率の高い材質の板(例えば、ガラスエポキシ板等)を傾

斜磁場コイル補強材3205として密接して貼り付ける。この貼り付けには、接着や傾斜磁場コイル21と一体でのモールド等を採用できる。

また、クライオ容器2の対向面25側の壁面厚さは、撮像空間(均一静磁場領域9)の磁場強度や均一性等の他の設計条件が許す限り厚くすることが望ましく、これによりトータルでの剛性を高めることが可能となる。さらに、図28では、固定部材3203を傾斜磁場コイル21の周縁部にしか配置してないが、一体化を促進するためには傾斜磁場コイル21の中央部にも配置することが望ましい。あるいは、傾斜磁場コイル21を接着によってクライオ容器2に固着することも可能である。

10

15

20

25

傾斜磁場コイル21を固定する固定部材3203は、傾斜磁場コイル補強材3205と傾斜磁場コイル21を貫通してクライオ容器2に強固に固定される。これにより、傾斜磁場コイル補強材3205と傾斜磁場コイル21をクライオ容器2に固定する。傾斜磁場コイル21には固定部材3203を通す貫通孔3203aが設けられる。貫通孔3203aの径は、貫通孔3203aの側面が固定部材3203と接触しない程度の大きさである方が望ましい。その理由は、固定部材3203が貫通孔3203a側面と接触すると、その接触している個所の位置や接触の程度によって傾斜磁場コイル21の固定具合が異なってしまい、この結果、MRI装置毎に振動モードが変化することになり、安定した性能を得られなくなるためである。/固定部材3203としてはボルトを用いることができ、その場合は、受け側であるクライオ容器2にはねじ穴を設ける。クライオ容器2にねじ穴を設ける十分な厚さを確保できない場合には、後述する図32の構成の台座3250を採用することができる。

このように第11の実施の形態のMRI装置は、傾斜磁場コイル21とクライオ容器2とを固定して一体化することにより、傾斜磁場コイル21およびクライオ容器2全体の剛性を高め、傾斜磁場コイル21の振動振幅を小さくすることが

できる。これにより、クライオ容器2に傾斜磁場コイル21から伝導する振動振幅も、一体化していない場合と比較して小さくすることができ、超電導磁石10 1 a、101bの振動を抑制することができる。

なお、第11の実施の形態の構成に加えて、第1~第7の実施の形態の厚板状補強部材51、54や格子状補強部材52、56の構成補強部材を固定することももちろん可能である。この場合、クライオ容器2の剛性をさらに向上させることができるため、超電導磁石101a、101bの剛性をいっそう低減することができる。

### (第12の実施の形態)

5

20

25

10 図29(a)および図29(b)には、本発明を適用したMRI装置の第12の実施の形態を示す。図29(a)および図29(b)には、簡単のために下部側の超電導磁石101bのみを示すが、上部側の超電導磁石101aも実質的に同様の構造を持ち、各構成要素は撮像空間(均一静磁場領域9)内中央の水平面に関して上下対称な配置となる。本実施形態では、傾斜磁場コイル21は撮像空15 間側から傾斜磁場を発生するための主コイル3213、中間部材3211、傾斜磁場を外部に漏らさないようにするためのシールドコイル3214を有する。

図29(a)の構成では、クライオ容器2全体の剛性を高めるために、クライオ容器2の対向面25側と反対向面26側とをクライオ容器補強材3210によって、強固に締結した構造としている。理由は次のとおりである。すなわち、対向面25側とは異なり、反対向面26側は均一静磁場領域9に面していないため、比較的寸法に余裕があるので、反対向面26側の壁面厚さを厚くすることは比較的容易である。このため、対向面25側よりも壁面厚を増して剛性を高めた反対向面26側壁面と対向面25側壁面とをクライオ容器補強材3210で締結することによって、対向面25側の壁面の剛性を高めることができる。

一方、図29(b)の構成では、図29(a)の補強材3210に代えて、ク

ライオ容器 2 を貫通する貫通孔 4 を設けている。貫通孔 4 の側壁が、クライオ容器 2 の対向面 2 5 と反対向面 2 6 とを締結するため、図 2 9 (a) と同様に対向面 2 5 側の壁面の剛性を高めることができる。また、図 2 9 (b) の構成では、対向面 2 5 に凹部 3 を設けているので、凹部 3 の内部に傾斜磁場コイル 2 1 を配置し、クライオ容器 2 に固定することができる。これにより、超電導磁石 1 0 1 b の厚さを低減することが可能であり、撮像空間を広く維持することができる。

また、図29(a)および図29(b)の構成では、固定部材3203は、中間部材3211に設けたザグリ穴3212に入れ、クライオ容器2に固定している。これにより、固定部材3203の長さを短くすることができる。傾斜磁場コイル21とクライオ容器2との一体化を更に向上させ、傾斜磁場コイル21とクライオ容器2の剛性を向上させることができる。図29(a)および図29(b)の構成では、傾斜磁場コイル21は主コイル3213とシールドコイル3214とを有するが、一般に、主コイル3213の方がシールドコイル3214よりも直径が小さいために、傾斜磁場コイル21の外周部をクライオ容器2に固定する場合、図29(a)、図29(b)のような構成で固定することが可能である。傾斜磁場コイル21の中央部をクライオ容器2に固定する場合においては、図1のように長い固定部材3203を用いることができる。

なお、中央部でも固定部材3203を短くするために、図32に示すような構造を採用することが可能である。この図32には傾斜磁場コイル21の一部断面を示すが、固定部材3203としての固定ボルトは、中間部材3211内に収容されている。固定ボルトは、主コイル3213の一部に設けられた穴3213aを通して操作される構成である。また、固定部材3203としてボルトを用いる場合、受け側であるクライオ容器2の壁面にある程度以上の厚さが必要であるが、クライオ容器2に十分な壁面厚さを確保できない場合には、後述する図32の台座3250を採用することができる。

このように、第12の実施形態の図29(a)および図29(b)の構成では、傾斜磁場コイル21を三層構造とするとともに、クライオ容器2の反対向面26の厚さを大きくし、さらに、クライオ容器補強材3210または貫通孔4を備える構造とした上で、傾斜磁場コイル21とクライオ容器2とを固定して一体化している。これにより、傾斜磁場コイル21とクライオ容器2の全体の剛性がさらに高まるため、超電導磁石101a,101bの振動をいっそう低減することが可能である。なお、傾斜磁場コイル21を三層構造とする構造、クライオ容器の反対向面26を厚くする構造、クライオ容器補強部材3210または貫通孔4を備える構造は、必ずしも共に実施しなければならないわけではなく、いずれか1つ以上を備える構造にすることができる。

なお、第12の実施の形態の構成に加えて、第1~第7の実施の形態の厚板状補強部材51、54や格子状補強部材52、56の構成補強部材を固定することももちろん可能である。この場合、クライオ容器2の剛性をさらに向上させることができるため、超電導磁石101a、101bの剛性をいっそう低減することができる。

#### (第13の実施の形態)

10

15

20

25

図30には、本発明を適用したMRI装置の第13の実施形態を示す。本実施形態では、クライオ容器2の対向面25側を強固にするために、中央部分に貫通孔3251を設けている。この貫通孔3251の側壁3251aは支柱としての役割を果たすために、対向面25の壁面の剛性を向上できる。貫通孔3251の位置としては、図30のように中央部に設けることに限らずオフセンターにした配置でも良いし、複数を設けても良い。設けた貫通孔3251は、ケーブル8(図30では不図示)や冷却用配管の経路としても利用することが可能である。あるいは、この貫通孔3251と傾斜磁場コイル21との密着性を高めておき、貫通孔3251の内部を真空に引くことで、傾斜磁場コイル21をクライオ容器2に

大気圧によって固着することも可能である。この場合、傾斜磁場コイル21側の 固定部分に関する構造が簡素化される利点がる。

また、図30の構造では、第11の実施の形態と同様の構造を持つ傾斜磁場コイル21とクライオ容器2との間に、非磁性・絶縁部材3220と非磁性・導電部材3221な配置している。非磁性・導電部材3221は、超電導磁石101a、101bの振動等により生じる静磁場の時間変動を、内部にその誘導電流である渦電流を生じさせ、静磁場の時間変動を抑制する。この技術は、例えば、WO02/071942号公報に記載されているものである。非磁性・導電部材3221は、アルミや銅等の電気伝導度の高い材質が好ましい。この非磁性・導電部材3221に穴を設けて、シム材を配置するためのトレーを兼用させることも可能である。この非磁性・導電部材3221の厚さとしては、数ミリ~30ミリ程度が好ましい。

10

非磁性・絶縁部材3220は、傾斜磁場コイル21のコイルパターン部分と非 磁性・導電部材3221などの電気導体部分との間隔を開くことにより、非磁性・ 導電部材3221に渦電流が過度に発生するのを抑制する。これにより、画質の 15 悪化を防止する。すなわち、傾斜磁場コイル21による渦電流を防ぐようにシー ルドコイル3214のパターンは設計するが、非磁性・導電部材3221との距 離が近すぎると渦電流を十分には抑制できない。よって、非磁性・絶縁部材32 20は、傾斜磁場コイル21のコイルパターン部分と非磁性・導電部材3221 20 などの電気導体部分との間隔を開くことにより、この問題を解決し、画質の低下 を防ぐことができる。非磁性・絶縁部材3220は厚いほど、渦電流の抑制効果 は高まるが、開放空間を確保するためには、他コンポーネントを薄くする必要が ある。よって、現実的には数ミリ〜十数ミリ程度が好ましい。又、この部分に、 モールドなどによってシムコイルを配置することで、寸法的に有効活用すること も可能である。 25

この第13の実施形態においては、傾斜磁場コイル21とクライオ容器2の間に挿入する上記の部材3220,3221は傾斜磁場コイル21と共に、クライオ容器2の壁面に強固に一体化される必要がある。このため、予め、非磁性・導電部材3221をクライオ容器2とを接着や溶接等により固着したり、非磁性・ 導電部材3221をクライオ容器2のクラッド材として形成することなどが可能である。ここで、クラッド材とは、異種金属を一枚の板に圧延し、それぞれの材料性を引き出すための複合材である。本実施形態においては、クライオ容器2の一般的な材料であるステンレス材と非磁性・導電部材3221に使用するアルミや銅等の電気伝導度の高い材質とを複合材とする。このことにより、各々の部 材の目的を達成すると共に、両者を一体化することにより剛性の向上が得られる。又、非磁性・絶縁部材3220と傾斜磁場コイル21とを接着やモールド等により一体化することも可能であり、そうすることで、取り付けなどの作業性も向上する。

第13の実施の形態のように、クライオ容器2に貫通孔4を設けることにより、 クライオ容器2の剛性を高めておき、クライオ容器2に傾斜磁場コイル21を固 定して一体化することにより、超電導磁石101a, 101bの振動を低減する ことができる。また、非磁性・導電部材3221と非磁性・絶縁部材3220を 配置することにより、超電導磁石101a, 101bの磁気特性を改善すること ができる。

20 なお、第13の実施の形態の構成に加えて、第1~第7の実施の形態の厚板状 補強部材51、54や格子状補強部材52、56の構成補強部材を固定すること ももちろん可能である。この場合、クライオ容器2の剛性をさらに向上させるこ とができるため、超電導磁石101a、101bの剛性をいっそう低減すること ができる。

25 (第14の実施の形態)

...

5

10

図31(a)、(b)には、本発明を適用したMRI装置の第14の実施形態を示す。図31(a)の中央固定部3204の拡大図を図31(b)に示す。本実施形態では、傾斜磁場コイル21を取り付けるための構造として、割りナット3301を利用した場合を示す。クライオ容器2の壁に割りナット3301を溶接や接着等により予め固着しておく。ここで、非磁性・絶縁部材3220は傾斜磁場コイル21に固着してある。この割りナット3301に、テーパー形状のネジ3302を挿入していくことにより、ナット3301の外周が拡張して、非磁性・絶縁部材3220の内壁を押すことで固定される。ネジ3302の代わりに、ナット3301の内周面をテーパー状にしておいても同様の作用が得られる。この固定方法の場合には、主コイル3213や中間部材3211に設ける穴の直径を小さくすることができるので、傾斜磁場コイル21の製作が容易となる利点がある。なお、図31(a)、(b)には、非磁性・導電部材3221を図示していないが、非磁性・導電部材3221を図示していないが、非磁性・導電部材3221を配置することももちろん可能である。

図32には、固定部材3203として固定ボルトを使用し、台座3250を使って固定ボルト3203を固定する場合の一実施形態を示す。中間部材3211 の撮影空間側には固定ボルト3203の頭の部分を収容する穴3211aが開けられ、中間部材3211の残りの部分とシールドコイル3214には固定ボルト3203の首下部分が貫通できる貫通孔3214aが開けられている。この貫通孔3214aは、その側面が固定ボルト203と接触しない程度の内径を持つのが望ましい。また、受け側であるクライオ容器2にはねじ穴を設ける。そのためクライオ容器2にある程度以上の壁面厚さが必要であるが、クライオ容器2に十分な厚さを確保できない場合には、クライオ容器2の対向面25側に台座3250を据え付け、非磁性・絶縁部材3220にはその台座3250を収容できる穴3220aを設けておく。これらの構成によって、固定ボルト3203の頭部分とクライオ容器2との間に中間部材3211とシールドコイル3214とを挟

んで固定する。

以上は、静磁場発生源として一対の超電導磁石を垂直方向に配置したMRI装置に本発明を適用した実施形態を説明したが、本発明のMRI装置は上記実施形態に限定されず、種々の変更が可能である。例えば、常電導コイルにおいても同様の構造を適用することが可能である。また、一対の静磁場発生源を水平方向に対向配置した構成も可能である。

さらに、それぞれの実施形態を個別に説明したが、複数の実施形態を組み合わせて、 せた構成も可能である。例えば、第12と第13の実施の形態を組み合わせて、 クライオ容器2にクライオ容器補強材3210と貫通孔3251を共に設けてク 10 ライオ容器2の剛性を高めることが可能である。あるいは、第11と第12の実 施形態を組み合わせて、第12の実施形態の傾斜磁場コイル21に第11の実施 形態の傾斜磁場コイル補強材3205を被せて傾斜磁場コイル21の剛性を向上 させることも可能である。

#### 請求の範囲

- 1. 撮像空間を挟んで対向配置された一対の静磁場発生源と、前記撮像空間に傾斜磁場を印加するためにそれぞれの前記静磁場発生源の前記撮像空間側に配置された傾斜磁場発生部とを有し、
- 5 前記静磁場発生源はそれぞれ、磁場発生コイルと、該コイルが内部に封入された密閉容器とを含み、

前記傾斜磁場発生部は、前記密閉容器の前記撮像空間側の面上に支持され、

前記密閉容器は、前記傾斜磁場発生部から発生する振動が該密閉容器を介して他に伝達されるのを防ぐために剛構造を備えることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

10

20

- 2. 請求項1に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記剛構造は、前記密閉容器の前記撮像空間側の面とこの面に向かい合う面とを密閉容器の内部で連結する少なくとも1つの連結部を有することを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
- 15 3.請求項2に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記剛構造は、前記 密閉容器の前記撮像空間側の面に対して向かい合う面に固定された剛性補強部材 をさらに有することを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
  - 4.請求項3に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記剛性補強部材は、 板状部材および格子状部材のうち少なくとも一方を含むことを特徴とする磁気共 鳴イメージング装置。
  - 5. 請求項4に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記板状部材は、前記密閉容器の前記撮像空間側の面に対して向かい合う面の壁面を、前記撮像空間側の面の壁面よりも厚くすることにより、前記密閉容器と一体に形成されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
- 25 6. 請求項1に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記傾斜磁場発生部

を前記密閉容器に固定する固定手段をさらに有し、前記傾斜磁場発生部は、前記 固定手段によって前記密閉容器に一体化されていることを特徴とする磁気共鳴イ メージング装置。

7. 請求項3ないし5のいずれか1項に記載の磁気共鳴イメージング装置におい 5 て、前記密閉容器はそれぞれ、前記撮像空間側の面に設けられた第1の凹部を備 え、

前記連結部は、その内部に前記撮像空間側の面からそれに対向する面へと貫通するように設けられた1以上の貫通孔を含み、

前記傾斜磁場発生部はそれぞれ、前記第1の凹部内に固定され、

- 10 前記貫通孔の少なくとも1つには、前記傾斜磁場発生部に電流を供給するための傾斜磁場用ケーブルが配置されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
  - 8. 請求項3ないし5のいずれか1項に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記密閉容器は、前記撮像空間側の面に向かい合う面に第2の凹部を有し、
- 15 該第2の凹部の内側に前記剛性補強部材が配置されていることを特徴とする磁気 共鳴イメージング装置。
  - 9. 請求項7記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記貫通孔は、前記第 1の凹部の側面近傍に配置されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装 置。
- 20 10.請求項7に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記貫通孔のうち少なくとも1つは、前記第1の凹部の略中央に配置されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
  - 11. 請求項7に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記剛性補強部材の内部には、前記貫通孔に通じる少なくとも1つの経路が設けられ、前記経路のうちの1つには前記傾斜磁場用ケーブルが配置されていることを特徴とする磁気

25

共鳴イメージング装置。

25

- 12. 請求項11に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記傾斜磁場発生部を冷却するための冷媒を循環させる手段をさらに有し、前記傾斜磁場発生部はその内部に前記冷媒を通過させる手段を備え、
- 5 前記貫通孔のうちの少なくとも1つ、および、それに通じる前記経路には、前記傾斜磁場発生部に前記冷媒を供給する配管が配置されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
- 13.請求項12に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記撮像空間に 高周波磁場を発生させるための一対の高周波磁場発生部をさらに有し、一対の高 10 周波磁場発生部のそれぞれは、前記傾斜磁場発生部よりも前記撮像空間側に配置 され、

前記貫通孔のうちの少なくとも1つ、および、それに通じる前記経路には、前記高周波磁場発生部に電流を供給するための高周波磁場用ケーブルが配置されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

- 15 14.請求項13に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記密閉容器の前記貫通孔は3以上設けられ、前記傾斜磁場用ケーブル、前記高周波磁場用ケーブルおよび前記配管は、それぞれ別々の前記貫通孔およびそれらにそれぞれ通じる別々の前記経路に配置されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
   15.請求項14に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記別々の経路は、前記剛性補強部材の内部で合流して、前記貫通孔の数よりも少ない数の経路となって該剛性補強部材の外部に通じる構成とされていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
  - 16. 請求項15に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記合流した前 記経路には、前記経路内の前記傾斜磁場用ケーブルまたは前記高周波磁場用ケー ブルが通過する空間と前記配管が通過する空間とを分離する仕切りが配置され、

該仕切りは熱伝導性の高い材料で構成されていることを特徴とする磁気共鳴イメ ージング装置。

- 17. 請求項16に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記配管は、前記傾斜磁場用ケーブルまたは前記高周波磁場用ケーブルよりも鉛直下側に配置されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
- 18. 請求項7に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記貫通孔は、前記第1の凹部の内側に開口を有し、前記傾斜磁場発生部は、前記貫通孔の開口の位置に電流受給端子を備え、前記傾斜磁場用ケーブルは電流供給端子を備え、前記電流供給端子が前記電流受給端子に接続されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

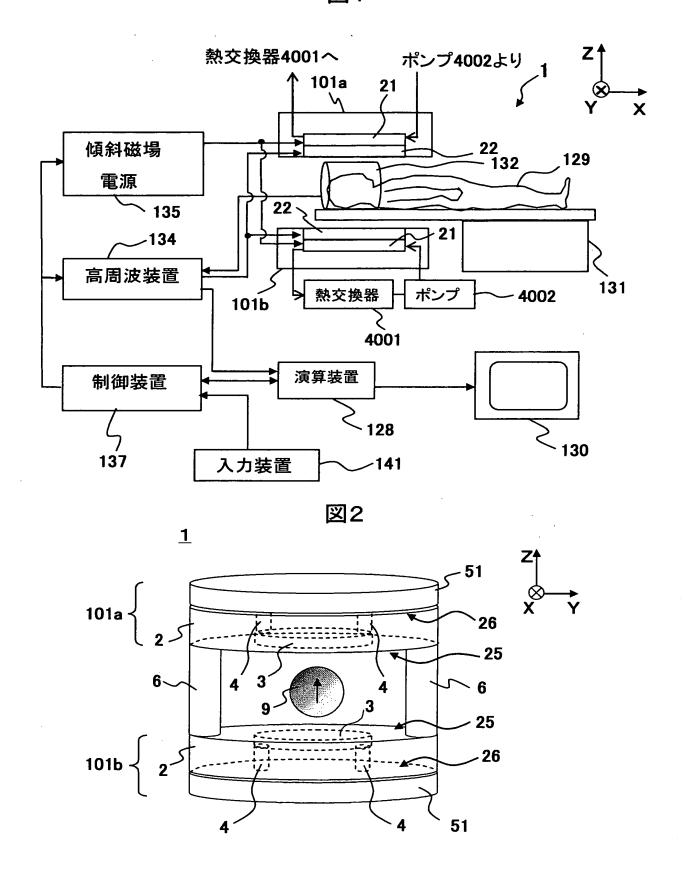
10

- 19.請求項7に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記傾斜磁場用ケーブルは、前記貫通孔内に固定部材によって固定されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
- 20.請求項12に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記貫通孔は、 前記第1の凹部の内側に開口を有し、前記傾斜磁場発生部は、前記貫通孔の開口 の位置に冷媒受給端子を備え、前記配管は冷媒供給端子を備え、前記冷媒受給端 子が前記冷媒供給端子に接続されていることを特徴とする磁気共鳴イメージング 装置。
- 21.請求項20に記載の磁気共鳴イメージング装置において、前記配管、前記 20 冷媒供給端子および前記冷媒受給端子は、導電性材料により構成され、前記傾斜 磁場発生部に電流を供給する傾斜磁場用ケーブルを兼用していることを特徴とす る磁気共鳴イメージング装置。

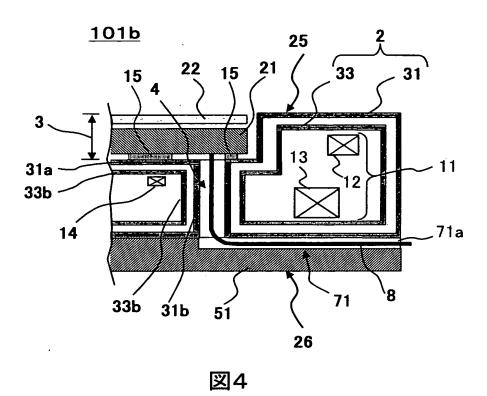
## 要約 書

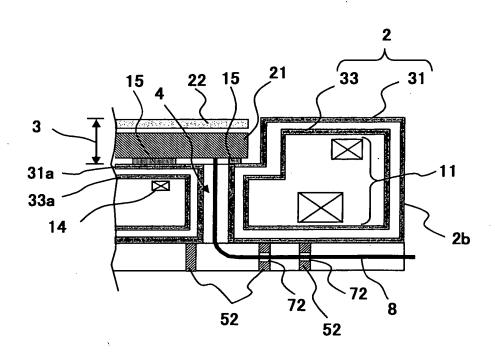
静磁場発生源の振動を低減する構成を有するMRI装置を提供する。静磁場発生源の密閉容器2は、傾斜磁場発生部21から発生する振動が密閉容器2を介して他に伝達されるのを防ぐための剛構造4を備える。剛構造4は、例えば撮像空間9側の面25からそれに対向する面26とを連結する連結部4を用いる。これにより、密閉容器の剛性が高まるため、傾斜磁場発生部から伝わる振動を低減できる。連結部は、貫通孔構造にすることが可能であり、その場合、貫通孔の内部空間をケーブルの引き回しに利用することができる。

図1



# 図3







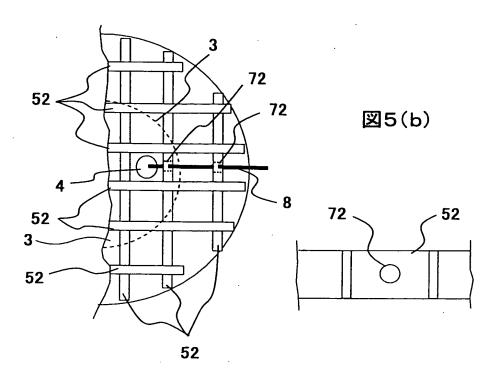


図6

<u>51</u>

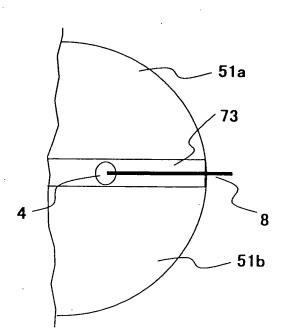


図7

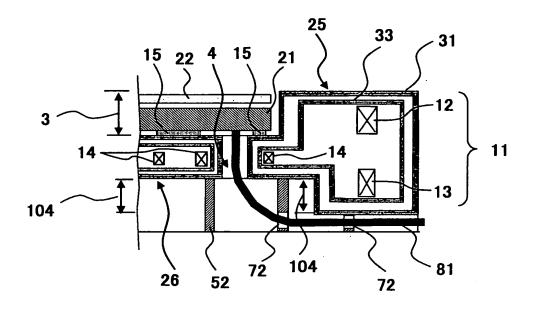
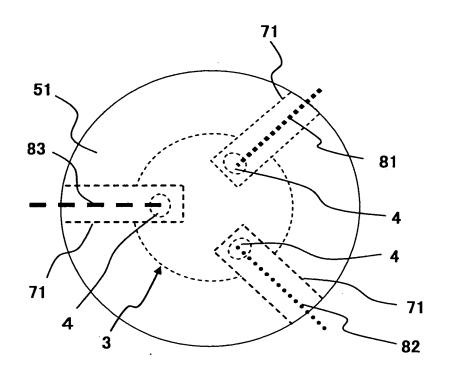
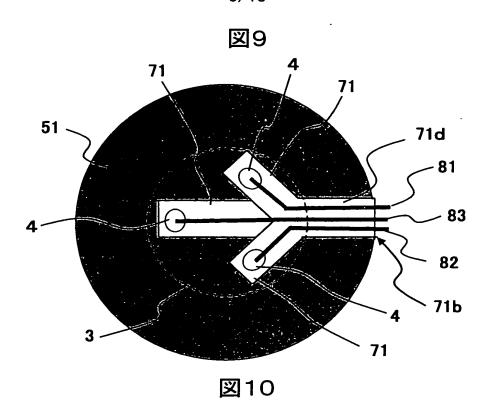


図8





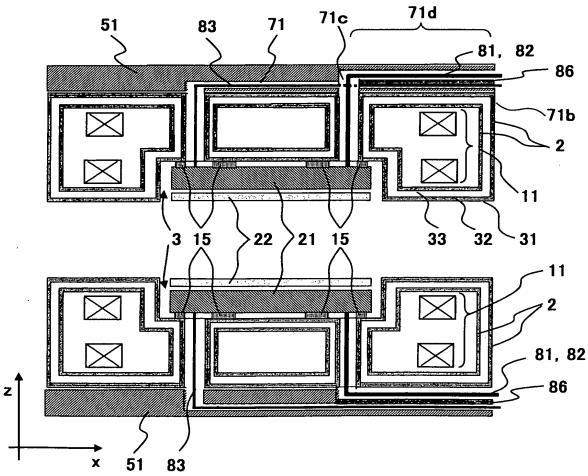


図11

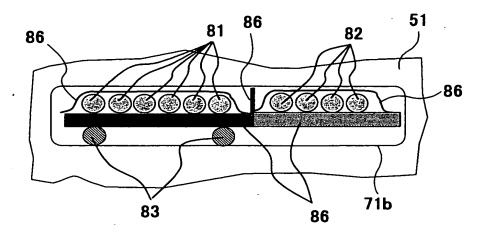


図12

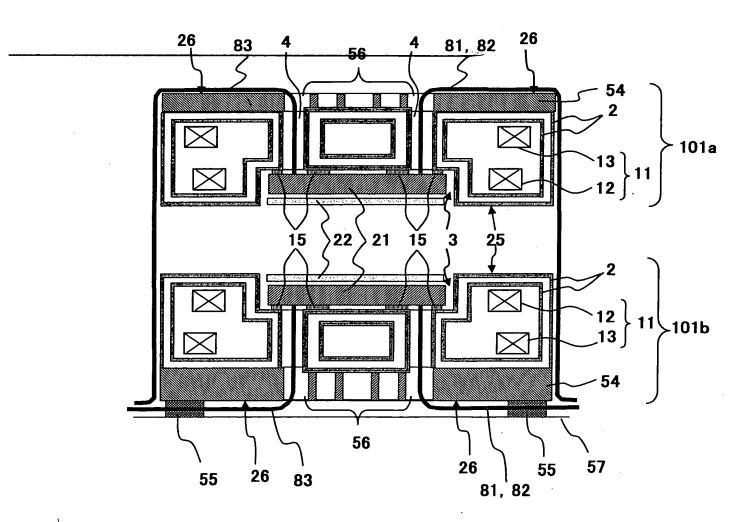


図13

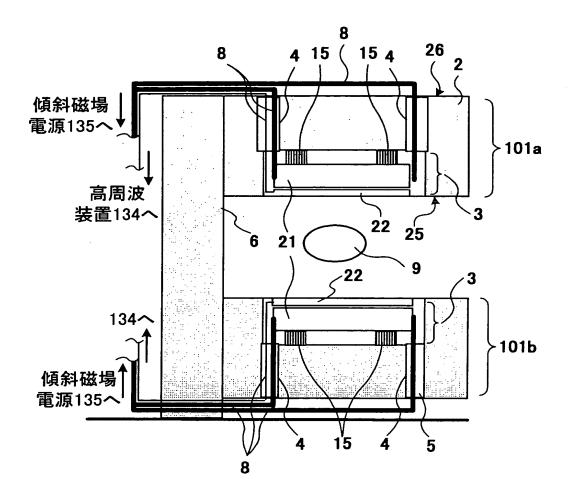


図14

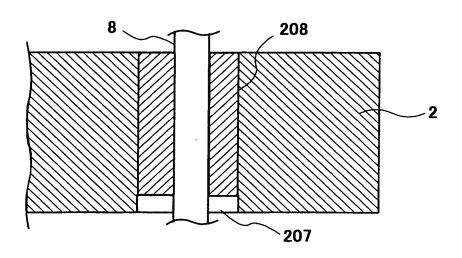




図15

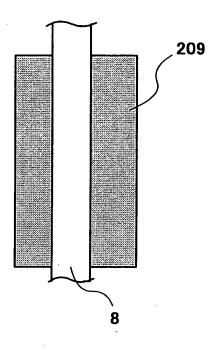
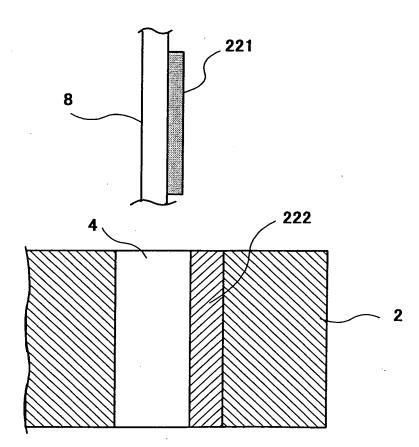


図16



9/18

図17

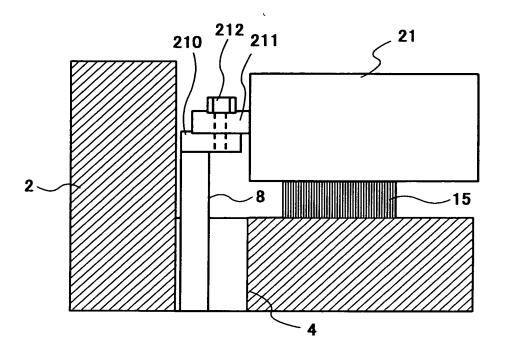


図18

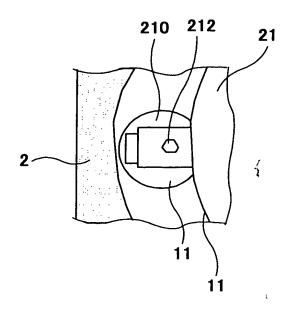


図19

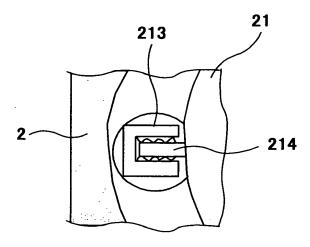
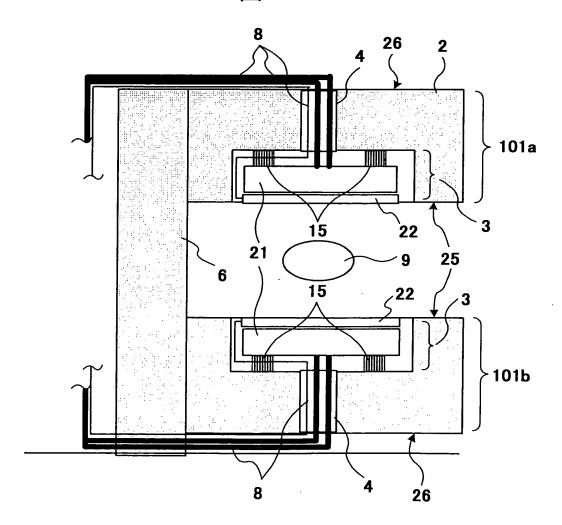
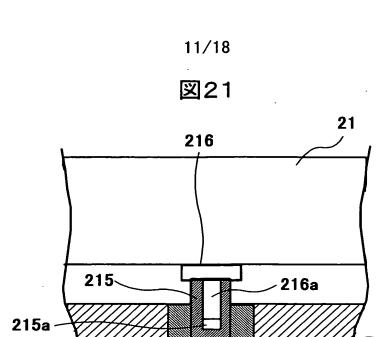
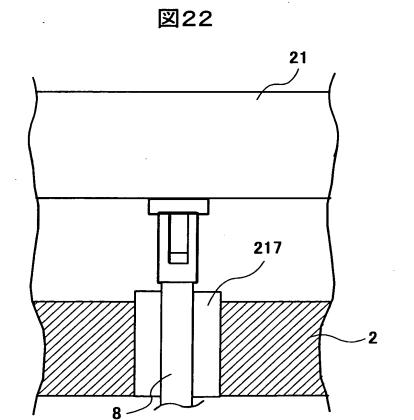


図20

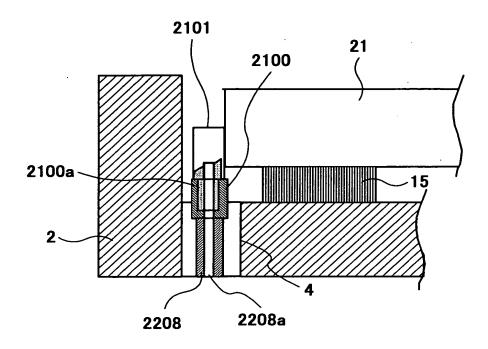


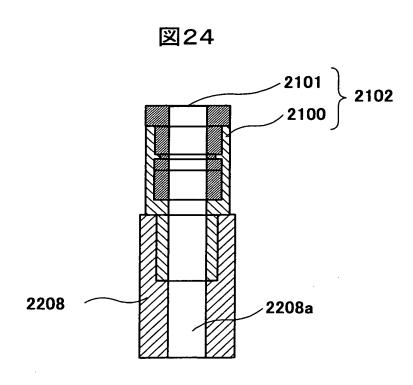




12/18

図23







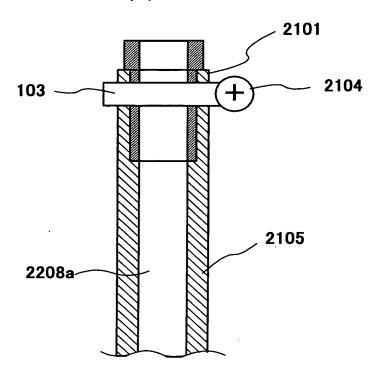


図26

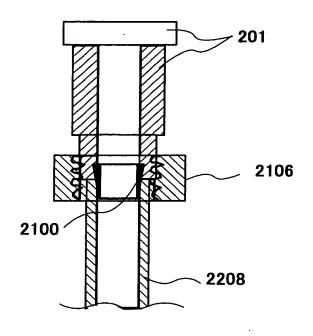


図27

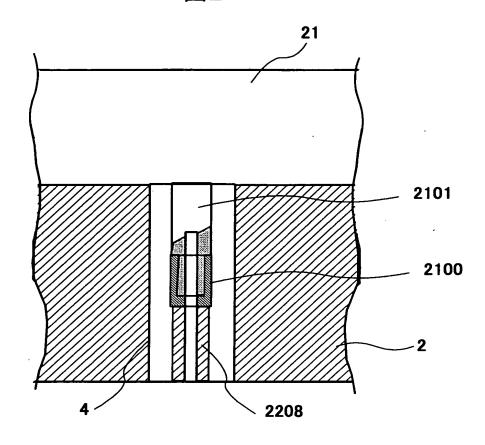
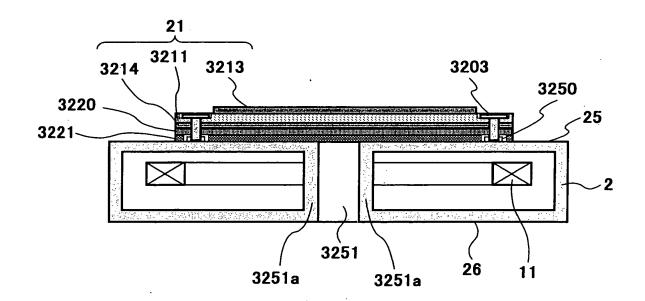


図30



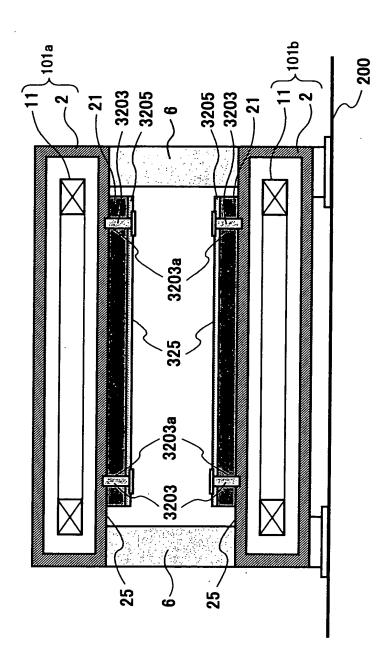
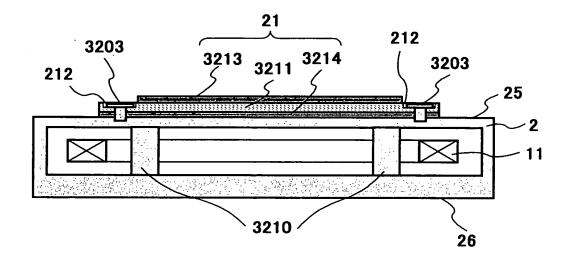


图28

## 図29(a)



## 図29(b)

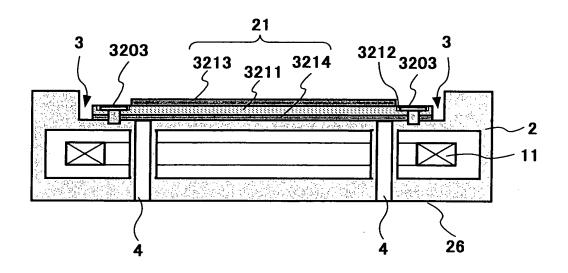


図31(a)

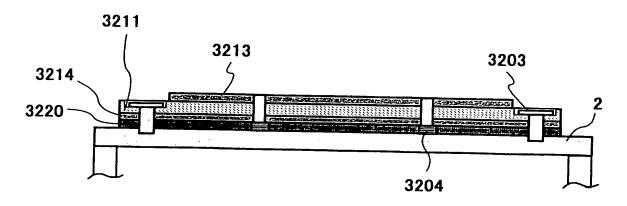


図31(b)

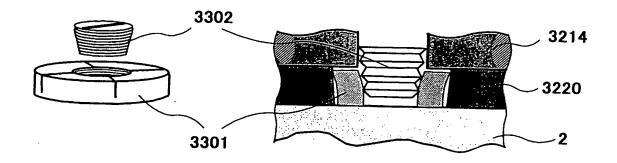
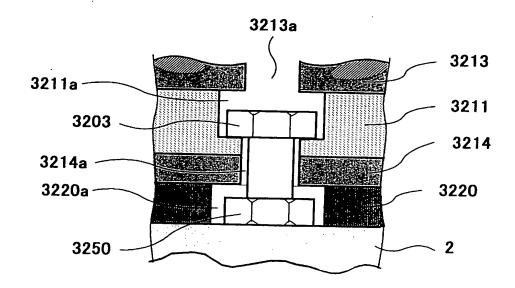
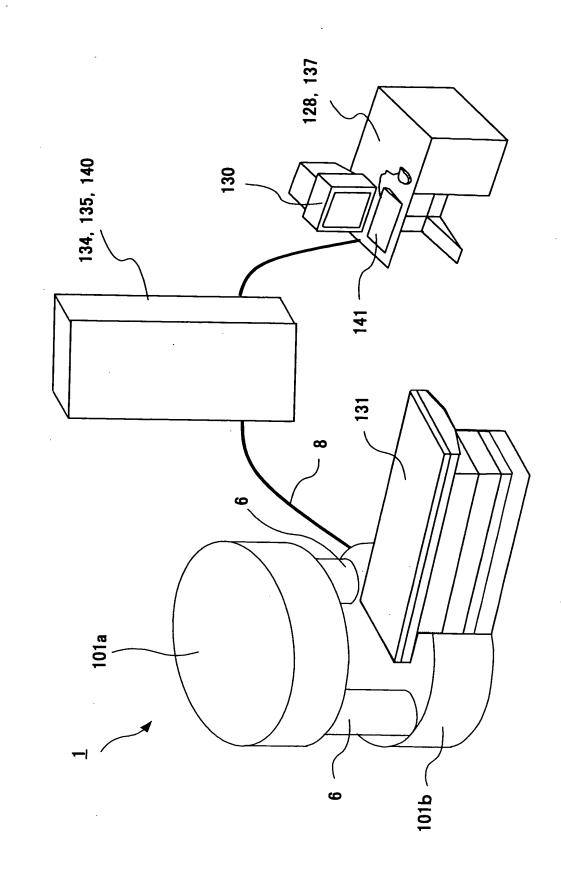


図32





**医**33